

高精度实时时钟 - SD2201RAM 充电型系列 (Ver1.4)

内置晶振、充电电池、串行 NVSRAM、I²C 总线接口、定时中断输出、数字精度补偿、免调校

SD2200 系列是一种具有内置晶振、支持 I²C 总线的高精度实时时钟芯片。该芯片可保证时钟精度为 ±5ppm (在 25±1℃ 下)，即年误差小于 2.5 分钟；该芯片内置时钟精度调整功能，可以在很宽的范围内校正时钟的偏差 (分辨力 3.052ppm 或 1.017ppm)；通过外置的温度传感器可设定适应温度变化的调整值，实现在宽温范围内高精度的计时功能；内置串行 NVSRAM 为非易失性 SRAM，擦写次数可达 100 亿次。内置充电电池，在电池满充的情况下可保证内部时钟走时超过一年时间，累计电量超过 1.1hA，电池使用寿命为五至八年。该芯片可满足对实时时钟芯片的各种需要，是在选用高精度实时时钟时的理想选择。

■ 主要性能特点：

- 低功耗：典型值 0.25 μA (VDD=3.3V, Ta=25℃，时钟电路部分)。
- 芯片工作电压范围：3.3~5.5V (其中 NVSRAM 在 4.5~5.5V 工作)，工作温度：民用级 0℃~70℃，工业级 -40℃~85℃。
- 年、月、日、星期、时、分、秒的 BCD 码输入/输出。
- 自动日历到 2099 年 (包括闰年自动换算功能)。
- 可设定两路闹钟 (定时) 及 32768Hz~1Hz 的方波信号输出。
- 内置高精度时钟调整功能。
- 内置 4kbit~256kbit 的非易失性 SRAM (B/C/D/E 型)，其擦写次数 100 亿次，且没有内部写延时。
- 内置 16bit 的通用寄存器。
- 内置电源掉电检测电路，具有上电和掉电标志位。
- 内置稳压电路，内部计时电压可低至 0.5V (参考值)。
- 内置电源管理电路，当 VDD ≥ 3.3V 时，内部电池不耗电。
- 内置充电电路，电池累计电量超过 1.1hA，使用寿命为 5~8 年。
- 内置晶振，出厂前已对时钟进行校准，保证精度 ±5ppm，即时钟年误差小于 2.5 分钟 (在 25±1℃ 下)。
- 内置电池使用寿命——一次性民用级：3~5 年，一次性工业级和充电型：5~8 年。
- 有工业级型号，其尾缀加 “I” 以示区分，如 “SD2201BPI” 为 SD2201BP 的工业级，“P” 标志为直插封装形式。SD2200A/B/C/D/EP 的封装形式：24 脚的 DIP 封装。

■ 管脚设置

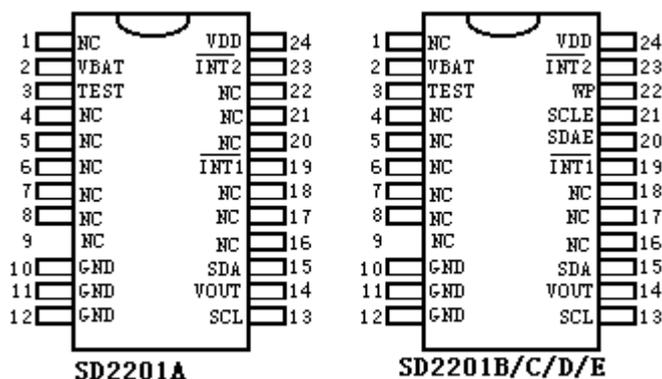


图 1 SD2200 系列管脚图

表1 SD2200 系列管脚功能表

| 管脚 | 名称 | 功能 | 特征 |
|------------------------------|------|--|--|
| 1、4、5、6、 7、8、16、 17、18 | NC | 没有与芯片内部连接 | 悬空或接地 |
| 2 | VBAT | 外加电池引脚 | 仅供时钟电路 |
| 3 | TEST | 内部电池电压测试脚 | 0.6~1.6V 为正常 |
| 10、11、12 | VSS | 负电源 (GND) | |
| 13 | SCL | 串行时钟输入脚, 由于在 SCL 上升/下降沿处理信号, 因此, 要特别注意 SCL 信号的上升/下降时间, 应严格遵守说明书。 | CMOS 输入 |
| 14 | VOUT | 3.3V 稳压输出脚, 当 $V_{DD} \geq 3.4V$ 时有效 | 可供电流 $\leq 30mA$, 电压精度 $3.3V \pm 2\%$. |
| 15 | SDA | 串行数据输入/输出脚, 此管脚通常用一电阻上拉至 V_{DD} , 并与其它漏极开路或集电器开路输出的器件通过“或”方式连接。 | N 沟道开路输出 CMOS 输入 |
| 19 | INT1 | 报警中断 1 输出脚, 根据 INT1 寄存器_1 与状态寄存器来设置其工作的模式, 当其时间一致时输出低电平“L”或时钟信号, 它需通过重写状态寄存器来禁止。 | N-沟道开路输出 |
| 20 | SDAE | E^2PROM 串行数据输入/输出脚, 此管脚通常用一电阻上拉至 V_{DD} , 并与其它漏极开路或集电器开路输出的器件通过“或”方式连接。 | N 沟道开路输出。 |
| 21 | SCLE | E^2PROM 串行时钟输入脚, 由于是在 SCLE 时钟输入信号的上升边缘和下降边缘来进行。因此请注意上升和下降时间, 并遵守技术规范。 | CMOS 输入。 |
| 22 | WP | 串行 RAM 保护脚, 当与 VCC 连接, 禁止写入; 当与 GND 连接时, 允许写入。 | CMOS 输入(仅当尾坠为 WP 的型号有此管脚)。 |
| 23 | INT2 | 报警中断 2 输出脚, 根据 INT1 寄存器_2 与状态寄存器来设置其工作的模式, 当其时间一致时输出低电平“L”或时钟信号, 它需通过重写状态寄存器来禁止。 | N-沟道开路输出 |
| 24 | VCC | 正电源 | 主电源 |

■ 原理框图

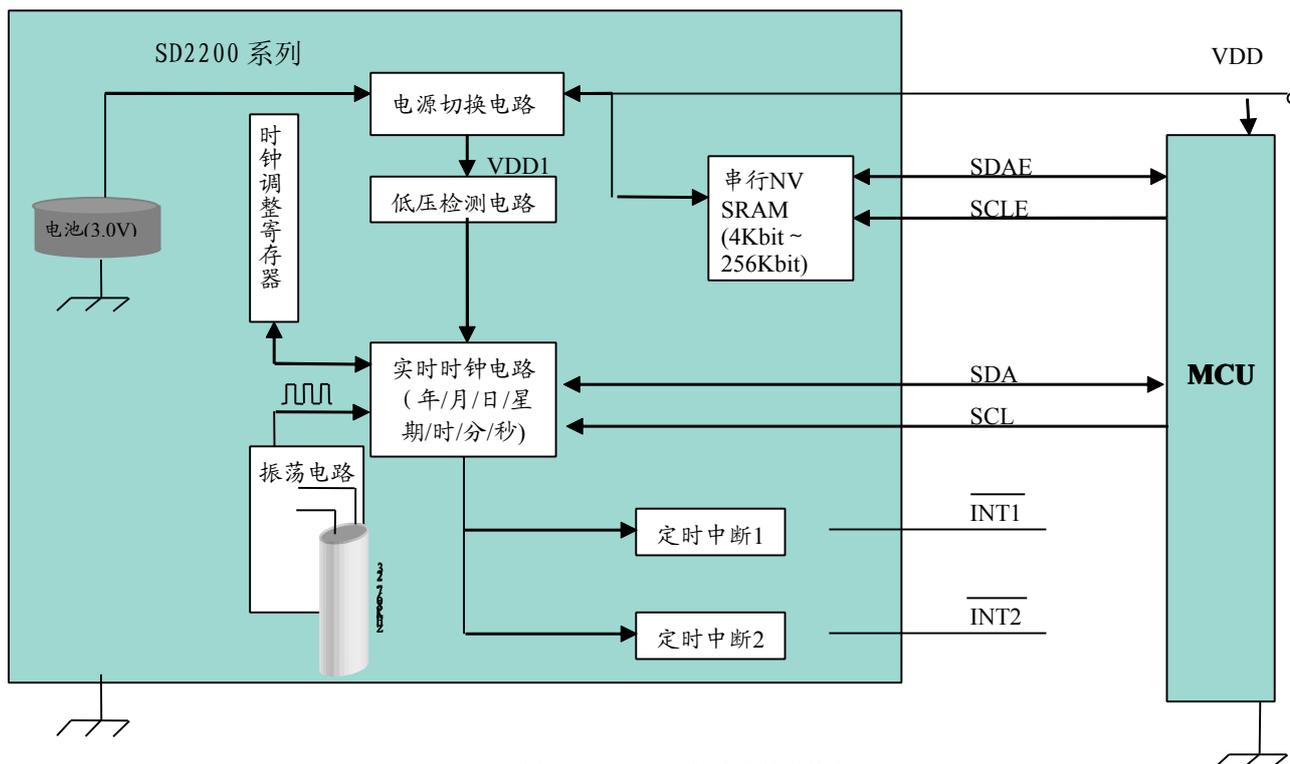


图 2 SD2200 系列功能框图

注：以上各图中 $\overline{INT1}$ 、 $\overline{INT2}$ 、SDA、SDAE 对 VDD 的上拉电阻均未标出，实际应用中要加上。

■ 实时时钟电路

1. 串行接口

SD2200 通过基于 I²C 总线的串行接口方式接收各种命令并读写数据。I²C 总线传输方式描述如下：

(1) 开始条件

当 SCL 处于高电平时，SDA 由高电平变成低电平时构成一个开始条件，对 SD2200 的所有操作均必须由开始条件开始。

(2) 停止条件

当 SCL 处于高电平时，SDA 由低电平变成高电平时构成一个停止条件，此时 SD2200 的所有操作均停止，系统进入待机状态。

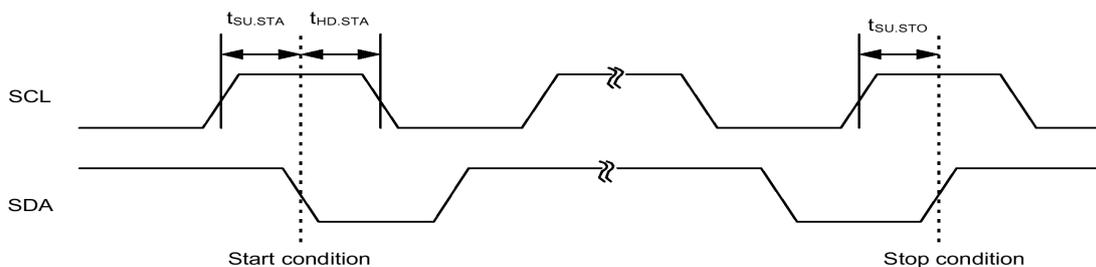


图 3 实时时钟的串行接口

(3) 数据传输

当 SCL 为低电平，且 SDA 线电平变化时，则数据由 CPU 传输给 SD2200；当 SCL 为高电平，且 SDA 线电平不变时，则 CPU 读取 SD2200 发送来的数据；当 SCL 为高电平，且 SDA 电平变化时，SD2200 收到一个开始或停止条件。

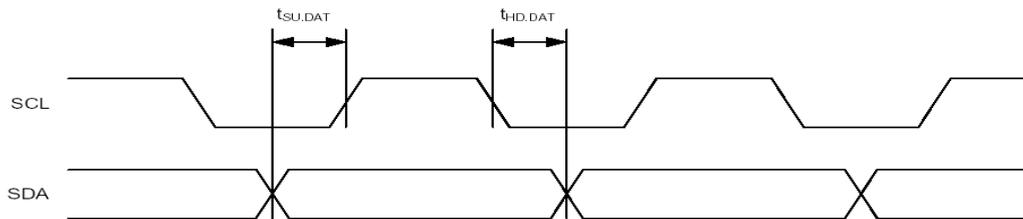


图 4 实时时钟数据传输时序

(4) 确认

数据传输以 8 位序列进行。SD2200 在第九个时钟周期时将 SDA 置位为低电平，即送出一个确认信号(Acknowledge bit,以下简称“ACK”),表明数据已经被其收到。

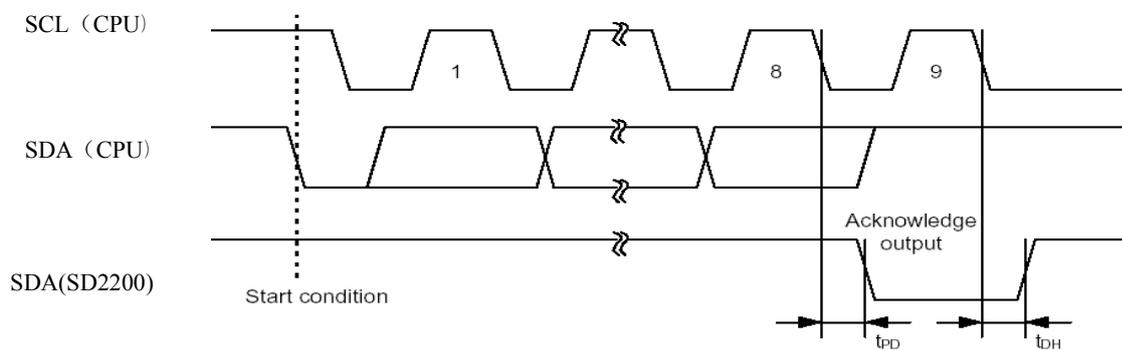


图 5 实时时钟确认信号

2. 操作指令

当 CPU 发出开始条件与实时时钟建立连接后，CPU 通过 SDA 总线连续输出 4 位器件地址，3 位操作指令和 1 位读/写指令，第 9 位是“ACK”位，由 SD2200 发出。

(1) 器件代码：

其中高四位称“器件代码”，它代表实时时钟的器件地址，固定为“0110”。

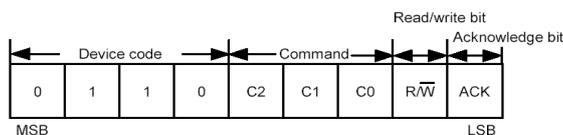


图 6 实时时钟器件代码

(2) 由三位操作指令构成对实时时钟操作的八条指令：

表2 实时时钟指令表

| 指令 | | | | 数据 | | | | | | | |
|----|----|----|---|---------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|--------|--------------------|---------|
| C2 | C1 | C0 | 内容 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| 0 | 0 | 0 | 读写状态寄存器_1 | POC*4 | BLD*4 | INT2*3 | INT1*3 | SC1*2 | SC0*2 | $\overline{12/24}$ | RESET*1 |
| 0 | 0 | 1 | 读写状态寄存器_2 | TEST*5 | INT2AE | INT2ME | INT2FE | 32kE | INT1AE | INT1ME | INT1FE |
| 0 | 1 | 0 | 读写方式1 (年数据~) | Y80 | Y40 | Y20 | Y10 | Y8 | Y4 | Y2 | Y1 |
| | | | | —*6 | —*6 | —*6 | M10 | M8 | M4 | M2 | M1 |
| | | | | —*6 | —*6 | D20 | D10 | D8 | D4 | D2 | D1 |
| | | | | —*6 | —*6 | —*6 | —*6 | —*6 | W4 | W2 | W1 |
| | | | | —*6 | $\overline{\text{AM/PM}}$ | H20 | H10 | H8 | H4 | H2 | H1 |
| | | | | —*6 | m40 | m20 | m10 | m8 | m4 | m2 | m1 |
| | | | | —*6 | s40 | s20 | s10 | s8 | s4 | s2 | s1 |
| 0 | 1 | 1 | 读写方式2 (时数据~) | —*6 | $\overline{\text{AM/PM}}$ | H20 | H10 | H8 | H4 | H2 | H1 |
| | | | | —*6 | m40 | m20 | m10 | m8 | m4 | m2 | m1 |
| | | | | —*6 | s40 | s20 | s10 | s8 | s4 | s2 | s1 |
| 1 | 0 | 0 | 设置 INT1 寄存器_1(报警时间1) INT1AE=1、INT1ME、INT1FE=0 | A1WE | —*6 | —*6 | —*6 | —*6 | W4 | W2 | W1 |
| | | | A1HE | $\overline{\text{AM/PM}}$ | H20 | H10 | H8 | H4 | H2 | H1 | |
| | | | A1mE | m40 | m20 | m10 | m8 | m4 | m2 | m1 | |
| | | | 读写 INT1 寄存器_ (选择频率占空比系数) INT1ME=0、INT1FE=1 | SC*7 | SC*7 | SC*7 | 16HZ | 8HZ | 4HZ | 2HZ | 1HZ |
| 1 | 0 | 1 | 设置 INT1 寄存器_2(报警时间2) INT2AE=1、INT2ME、INT2FE=0 | A2WE | —*6 | —*6 | —*6 | —*6 | W4 | W2 | W1 |
| | | | A2HE | $\overline{\text{AM/PM}}$ | H20 | H10 | H8 | H4 | H2 | H1 | |
| | | | A2mE | m40 | m20 | m10 | m8 | m4 | m2 | m1 | |
| | | | 读写 INT1 寄存器_2 (选择频率占空比系数) INT2ME=0、INT2FE=1 | SC*7 | SC*7 | SC*7 | 16HZ | 8HZ | 4HZ | 2HZ | 1HZ |
| 1 | 1 | 0 | 时钟调整用寄存器 | V7 | V6 | V5 | V4 | V3 | V2 | V1 | V0 |
| 1 | 1 | 1 | 通用寄存器 | F7 | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | F1 | F0 |

注意：(*1) Write only 标记，通过把“1”写入这个寄存器，而进行 IC 复位。

(*2) Scratch 位，用户可自由地读出或写入的寄存器。

(*3) Read Only 标记，一读出就会被清除，仅在 ALARM 设定时有效。

(*4) Read Only 标记，“POC”在电源上电时变为“1”，一读出就会被清除。

(*5) 为测试用，通常情况下请设置为“0”。

(*6) 即使写入也无效，在读出时为“0”。

(*7) 可读出/写入的寄存器，对中断不产生任何影响。

(3) 实时时钟读/写位

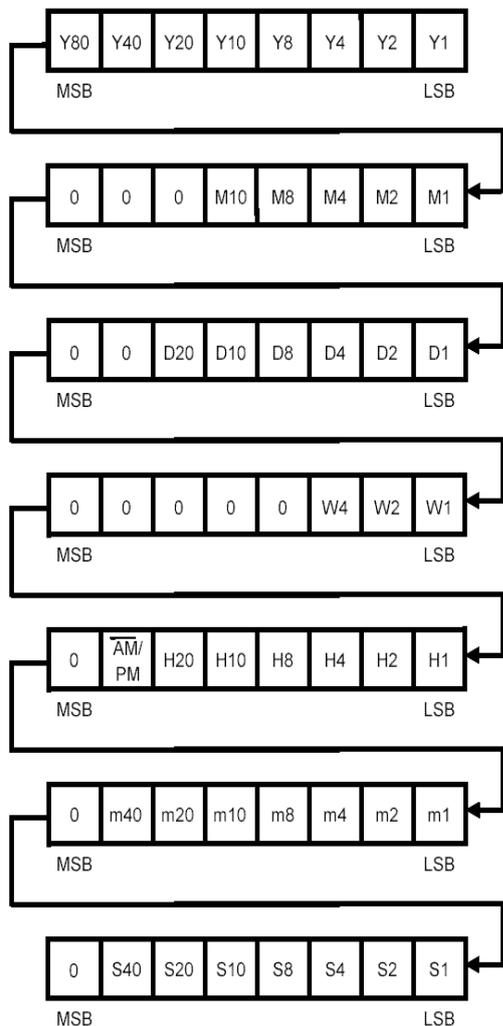
表3 实时时钟读/写指令表

| 操作 | 器件代码 | 操作指令 | R/ $\overline{\text{W}}$ |
|----|------|------|--------------------------|
| 读 | 0110 | 如指令表 | 1 |
| 写 | 0110 | 如指令表 | 0 |

3. 寄存器

(1) 实时数据寄存器

实时数据寄存器是一个 56 位的存储器，它以 BCD 码方式存贮，包括年、月、日、星期、时、分、秒的数据。实时数据的读/写操作都通过发送或接收年(实时数据读写方式 1)数据的第一位“LSB”开始执行的。



年数据 (00~99): 设置最后两位数字 (00~99)，通过自动日历功能计至 2099 年。

月数据 (01~12) 每月包含天数通过自动日历功能来更改。

1,3,5,7,8,10,12: 1~31

4,6,9,11: 1~30

2(闰年): 1~29

2 (普通): 1~28

日数据 (01~31)

星期数据 (00~06): 七进制计数器，00 对应星期天,01 对应星期一,依次类推。

小时数据 (00~23 或 00~11) 12 小时进制 0: AM, 1:PM 对于 24 小时进制，这一位没有意义但芯片内部必须将其设置为“0”或“1”。

分数据 (00~59)

秒数据 (00~59) 以及测试标志

图 7 实时时钟实时数据寄存器

特别注意:在 24 小时制式下,读取实时数据时一定要屏蔽小时的第 6 位(MSB)至 0.

(2) 状态寄存器_1

状态寄存器_1 是一个 8 位寄存器，可进行各种模式的表示与设置。

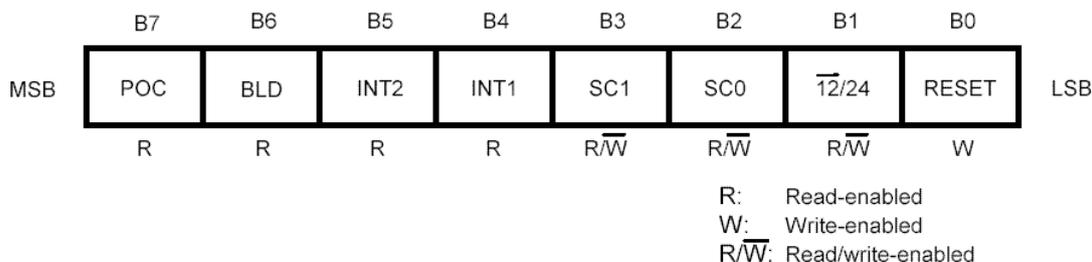


图 8 实时时钟状态寄存器_1

B7: POC 在系统上电时(即原理框图 VDD1 处)，电源电压检测电路工作，此位置“1”。该位一旦置“1”，即使 VDD1

处电压达到或超过检测电压，此位也不会变为“0”，而必须通过操作指令中的复位命令才能使之复“0”。本标志位为只读位，可读出状态寄存器_1 存取指令。在此标志为“1”的情况下，请先进行初始化。

B6: BLD 电源电压检测电路在检测电压 (V_{DET}) 以下时变为“1”，因此可以检测到 VDD1 处电压的降低，一旦变为“1”，即使电压 VDD1 在检测电压 (V_{DET}) 以上也不会变为“0”，这个标记为只读出标记，可对状态寄存器_1 存取指令，读出后自动变为“0”，在这个标志为“1”的情况下，请务必进行初始化。

B5、B4 : INT2, INT1

使用报警中断功能从 $\overline{INT1}$ 脚（或 $\overline{INT2}$ 脚）输出中断信号时，当通过 $\overline{INT1}$ 脚设定中断时，INT1 标志变为“1”，当通过 $\overline{INT2}$ 脚设定中断时，INT2 标志变为“1”。

B3、B2: SC1、SC0

2 位通用寄存器，可在内部工作电压范围（1.3~5.5V）内进行读出与写入

B1: 12/24 本标志用于设置 12 小时制或 24 小时制:

0: (12 小时制)

1: (24 小时制)

B0: RESET 通过设定此位为“1”，可进行 IC 内部的初始化，因为是只写位，在读出时一直为“0”。另外，在 IC 上电时，请勿必将此位置“1”。

(3) 状态寄存器_2

状态寄存器_2 是一个 8 位寄存器，可对各种模式进行设定或状态指示。

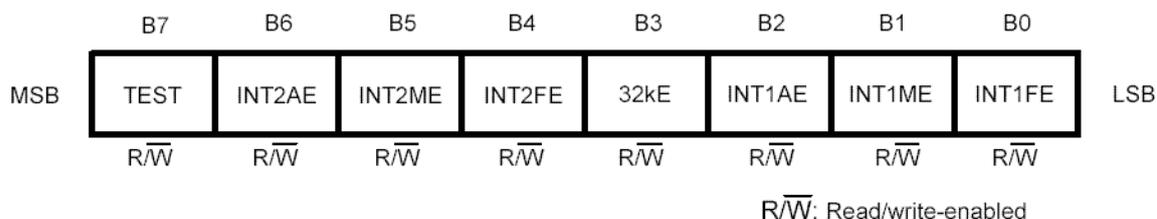


图 9 状态寄存器_2

B7: TEST 是为了 IC 测试而准备的，当将 TEST 标志置“1”，IC 进入测试模式，当该标志为“1”时，请使状态寄存器_1 的复位标志置“1”，进行初始化后该位变为“0”。

B6: INT2AE、 B5: INT2ME 、 B4: INT2FE

从 $\overline{INT2}$ 脚选择输出模式，模式选择如下。另外在使用报警功能 2 时，请在报警中断模式设置后，读写到 INT1 寄存器_2 中。

表 4 中断模式一览表 ($\overline{INT2}$ 脚)

| INT2AE | INT2ME | INT2FE | $\overline{INT2}$ 脚输出模式 |
|--------|--------|--------|-------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 无中断 |
| *1 | 0 | 1 | 选择固定频率中断 |
| *1 | 1 | 0 | 每分钟边沿中断 |
| 0 | 1 | 1 | 每分钟固定中断 1 (占空比 50%) |
| 1 | 0 | 0 | 报警中断 |

B3: 32KE、 B2: INT1AE、 B1: INT1ME、 B0: INT1FE

从 $\overline{INT1}$ 脚选择输出模式，模式选择如下所示。另外，在使用报警 1 功能的情况下，请在报警中断模式设定后，存取到 INT1 寄存器_1。

表 5 中断模式一览表 ($\overline{\text{INT1}}$)

| 32kE | INT1AE | INT1ME | INT1FE | $\overline{\text{INT1}}$ 脚输出模式 |
|------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 无中断 |
| 1 | *1 | *1 | *1 | 32kHz 输出 |
| 0 | *1 | 0 | 1 | 选择固定频率中断 |
| 0 | *1 | 1 | 0 | 每分钟边沿中断 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 每分钟固定中断 1 (占空比 50%) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 报警中断 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 每分钟固定中断 2 |

*1: 不用关心赋值 (0、1 均可)

(4) INT1 寄存器_1、INT1 寄存器_2

INT1 寄存器_1 和 INT1 寄存器_2 是可单独设定的中断设置寄存器，中断信号分别从 $\overline{\text{INT1}}$ 脚和 $\overline{\text{INT2}}$ 脚输出，功能转换由状态寄存器_2 来进行。

A、报警中断

INT1 寄存器_1 和 INT1 寄存器_2 用来存放报警时间数据，其格式用 BCD 码代表星期、小时与分钟，与实时数据寄存器中的星期、小时和分钟寄存器设置相同。同样，数据设置必须与在状态寄存器中的 12 小时制或 24 小时制一致，不要设置任何不存在的时间。

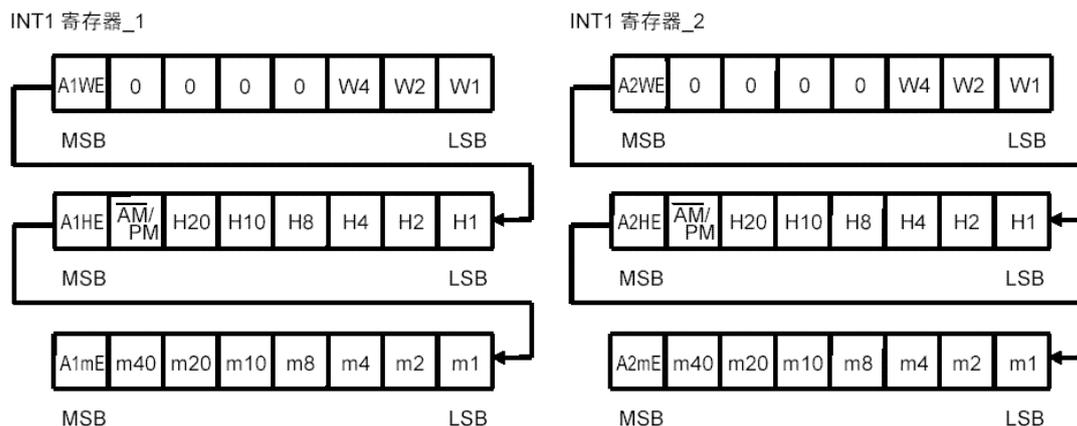


图 10 INT1 寄存器_1、INT1 寄存器_2 (报警时刻数据)

在 INT1 寄存器_1，各个字节的 MSB 备有 A1WE，A1HE 和 A1mE，通过设置这些位为“1”，使各字节所相应的星期数据、小时数据、分钟数据变为有效。INT1 寄存器_2 的 A2WE，A2HE 和 A2mE 也相同。

例如:定 INT1 寄存器_1 的报警时刻为“下午 7 点 00 分”

(1) 12 小时制时(状态寄存器_1 B1=0)时

→ 设定为 PM7:00

向 INT1 寄存器_1 的写入

| | | | | | | | |
|----|-----|----|----|----|----|----|-----|
| 星期 | 0 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 时 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MSB | | | | | | LSB |

*1. Don't care (0, 1均可)

(2) 24 小时制时(状态寄存器_1 B1=1)时

→ 设定为 PM19:00

向 INT1 寄存器_1 的写入

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 星期 | 0 | —*1 | —*1 | —*1 | —*1 | —*1 | —*1 | —*1 |
| 时 | 1 | 1*2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MSB LSB

*1. Don't care (0, 1均可)
 *2. 在设定时刻时,也要设定 $\overline{AM/PM}$ 标识。

B、选择固定频率中断

INT1 寄存器_1 和 INT1 寄存器_2 用来存放频率占空比系数，通过将 B4~B0 位置“1”，使其对应频率以“与”的方式输出，另外，SC 为 3 通用寄存器，可在内部工作电压范围（1.3~5.5V）内进行读出与写入，而不影响频率输出。

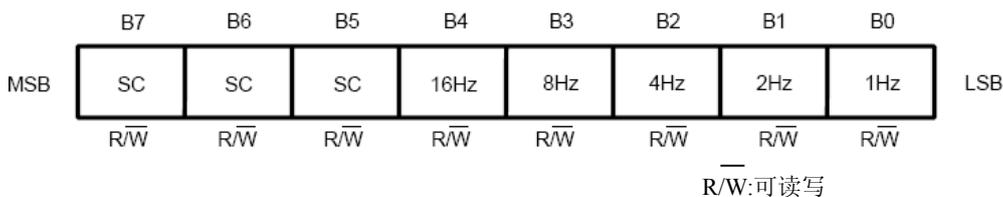


图 10 INT1 寄存器_1、INT1 寄存器_2(频率占空比数据)

例如: B4~B0=0Ah 时

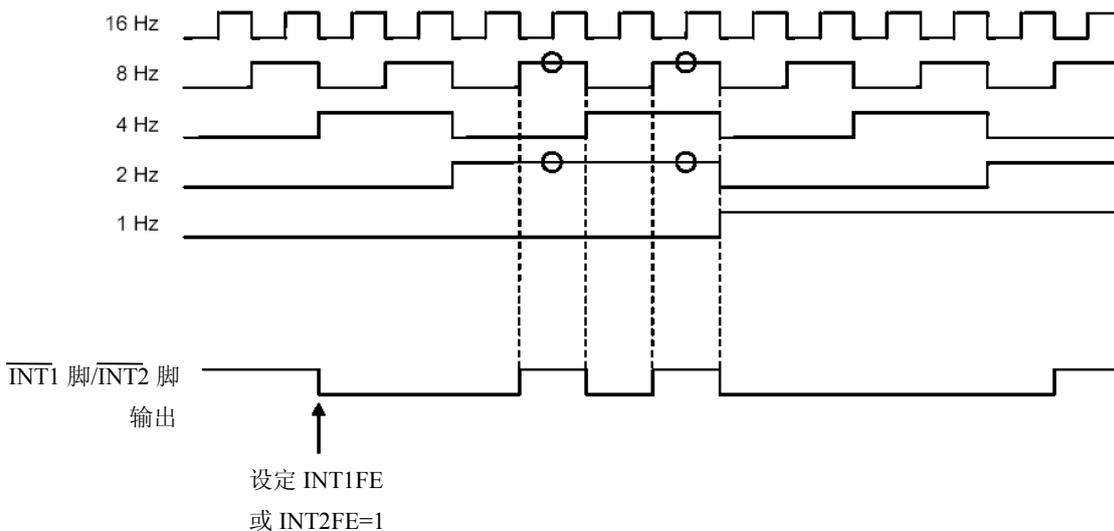


图 11 INT1 寄存器_1 或 INT1 寄存器_2（频率占空比数据）输出

(5) 时钟调整寄存器

时钟调整寄存器为单字节寄存器，是用来对实时数据进行逻辑校正而准备的。在不使用时钟调整寄存器时，请将时钟调整寄存器设定为“00h”。

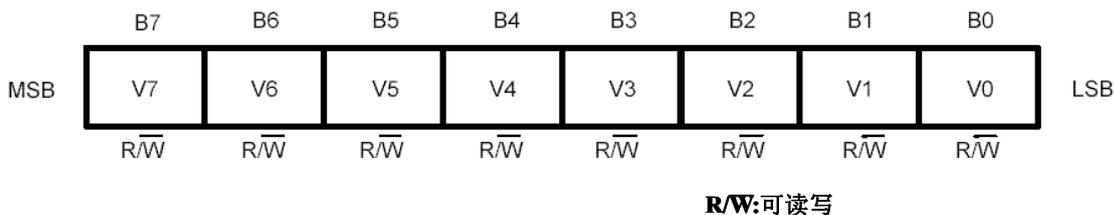


图 12 时钟调整寄存器

(6) 通用寄存器

通用寄存器为用户可自由设定单字节 SRAM 寄存器，可在工作电压范围（1.3~5.5V）内进行读出与写入

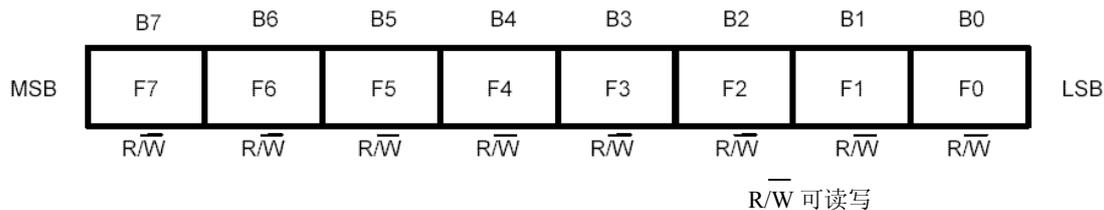


图 13 通用寄存器

4. 电源检测及初始化

(1) V_{DD1} 上电检测

V_{DD1} 是芯片内部的外电源 VDD 和内部电池切换的输出端的电压。在 V_{DD1} 上电时，SD2200 中的电源上电检测电路工作并将内部状态寄存器_1 的第 7 位 (标志位 POC) 置为“1”。当置为“1”后，即使 V_{DD1} 电压达到或超过检测电压(V_{DET})时，该值也一直保持不变。当电源标志位为“1”时，必须从 CPU 发送复位命令*1 来进行芯片的初始化。

当 V_{DD1} 电源上电时，由 INT1 脚输出 1Hz*2 频率。

*1: 复位是通过置状态寄存器_1 的第 0 位 (RESET 位) 置为“1”来实现的。

*2: 由于 V_{DD1} 电压上电时的状态不同，1HZ 的时钟有可能不被输出，此时，请设定状态寄存器_2 以及 INT1 寄存器_2 为 1HZ 输出。

(2) V_{DD1} 掉电检测

SD2200 内置了电源掉电检测电路，该电路每隔 1 秒进行一次采样时间为 15.6ms 的采样工作。若电源电压降低于检测电压 (V_{DET}) 以下，则 BLD 锁存电路将锁定“H”电平,内部状态寄存器_1 的第 6 位(BLD 标志)设置为”1”,并停止采样。仅当随后是读状态寄存器_1 命令或复位命令时,BLD 位将被复位为”0”并恢复采样。所以可通过读 BLD 标志位来检测电源电压的下降。如下图所示:

注: 1.在检测电压和释放电压之间有约 0.15V(Typ.)的滞后幅度。

2.在 BLD 读为”1”时,为了保证数据的可靠性,请务必进行复位初始化。

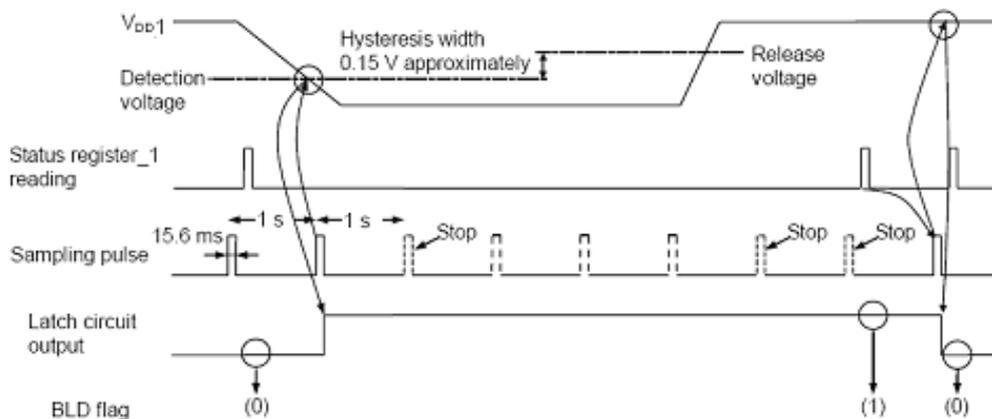


图 14 电源检测时序图

(3) 初始化(复位)

当接收初始化复位命令时，各寄存器将变为如下值：

实时数据寄存器：00（年），01（月），01（天），0（星期），00（分），00（秒）

状态寄存器_1：“0000B3B2B10b”(B3、B2、B1 设定为执行初始化时的状态寄存器_1 的 B3、B2、B1 数据)

状态寄存器_2：“00h”

INT1 寄存器_1：“00h”

INT2 寄存器_2：“00h”

时钟调整寄存器：“00h”

通用寄存器：“00h”

5. 读/写数据

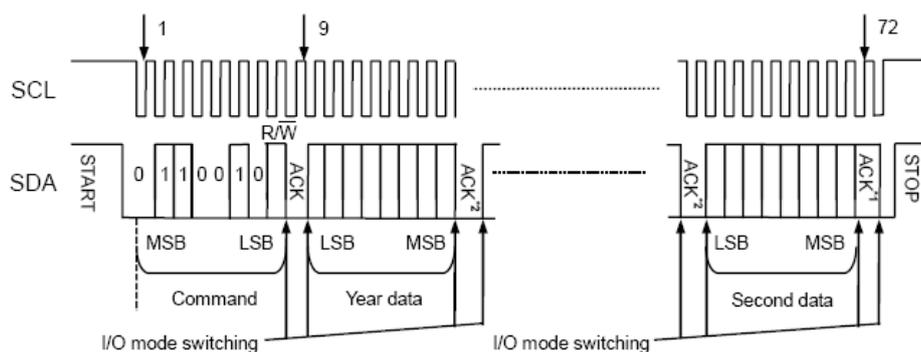
(1) 读数据

当检测到开始条件后，实时时钟接收器件代码和命令。当读/写位为“1”时，此时进入实时时钟读取模式或状态寄存器读取模式，数据则从 LSB 依次输出。每读完一个字节，MCU 要向 SD2200 发送 ACK 或 NO_ACK 信号；当 SD2200 收到 ACK 信号，将继续发送下一个数据；当 SD2200 收到 NO_ACK 信号将停止向 MCU 发送数据，而随后的停止条件将结束本次的读数据操作。

(2) 写数据

当检测到开始条件后，实时时钟开始接收器件代码和命令。当读/写位为“0”时，此时进入实时时钟数据写模式或状态寄存器写模式，数据必须按顺序从 LSB 位开始依次输入。在实时时钟数据写入时，如有 ACK 信号紧跟着实时时钟数据写命令，则日历和时间计数器将被复位，并将停止内部时间累加操作。继续接收完分钟数据及秒数据，此时月末数据将被修正。当 SD2200 接收完秒数据同时发出 ACK 信号给 CPU，从此新的计时开始。

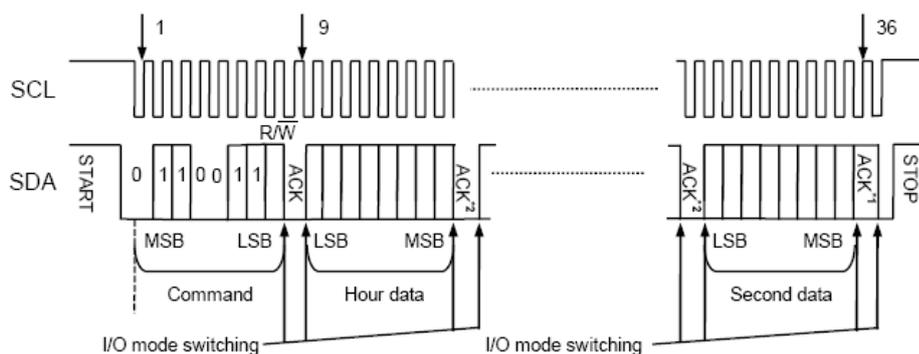
i. 实时时钟数据读/写 1(七字节数据:年-月-日-星期-小时-分钟-秒)



- *1. 在读数据时,请设定 NO_ACK=1.
- *2. 在读数据时,请设定是 MCU 送 ACK 信号至 SD2200.

图 15 实时时钟数据读/写 1

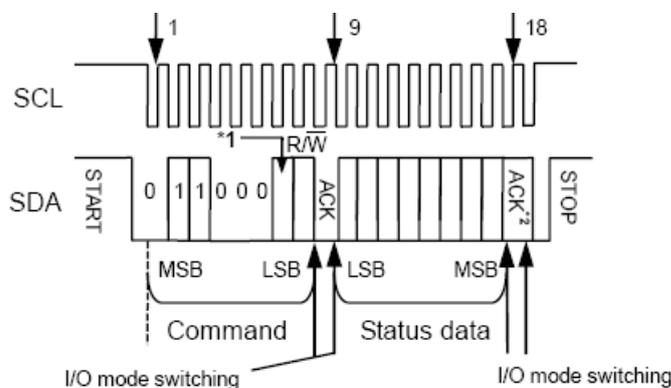
ii. 实时时钟数据读/写 2(三字节数据:小时-分钟-秒)



- *1. 在读数据时,请设定 NO_ACK=1.
- *2. 在读数据时,请设定是 MCU 送 ACK 信号至 SD2200.

图 16 实时时钟数据读/写 2

iii. 状态寄存器_1、状态寄存器_2 读/写



- *1. 0: 选择状态寄存器_1, 1: 选择状态寄存器_2
- *2. 读操作时, 将 NO-ACK 置 1

图 17 状态寄存器_1、状态寄存器_2 读/写

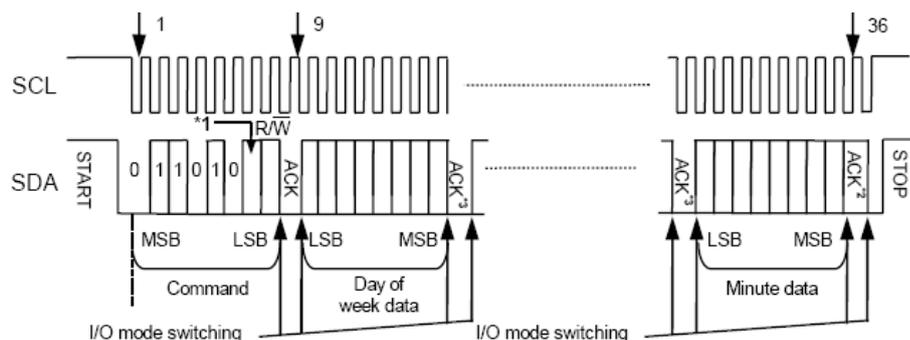
iv. INT1 寄存器_1 读/写、INT1 寄存器_2 读/写

INT1 寄存器_1 写入/读出的数据会因状态寄存器_2 设定的不同而不同, 故请务必在状态寄存器_2 设定后, 再进行 INT1 寄存器_1 的设置。INT1 寄存器_1 在报警中断时(其可通过置状态寄存器_2 的 INT1AE=1、INT1ME=0、INT1FE=0 来设定)为 3 字节的报警时刻数据寄存器,其他情况即选择固定频率中断时 (其可通过置状态寄存器_2 的 INT1ME=0、INT1FE=1 来设定) INT1 寄存器_1 为 1 字节的寄存器,该寄存器为频率占空比系数。

注意: INT1 寄存器_1 不能同时为报警数据或频率占空比系数数据。

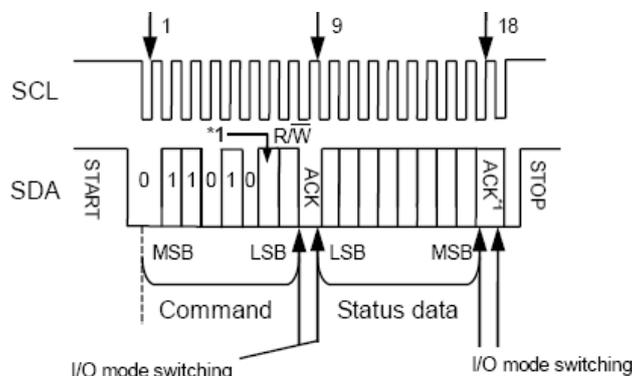
INT1 寄存器_2 写入/读出的数据会因状态寄存器_2 设定的不同而不同, 故请务必在状态寄存器_2 设定后, 再进行 INT1 寄存器_2 的设置。INT1 寄存器_2 在报警中断时(其可通过置状态寄存器_2 的 INT2AE=1、INT2ME=0、INT2FE=0 来设定)为 3 字节的报警时刻数据寄存器,其他情况即选择固定频率中断时 (其可通过置状态寄存器_2 的 INT2ME=0、INT2FE=1 来设定) INT1 寄存器_2 为 1 字节的寄存器,该寄存器为频率占空比系数。

注意: INT1 寄存器_2 不能同时为报警数据或频率占空比系数数据。



- *1. 0: 选择 INT1 寄存器_1, 1: 选择 INT1 寄存器_2
- *2. 读操作时, 将 NO-ACK 置 1
- *3. 在读数据时, 请设定是 MCU 送 ACK 信号至 SD2200.

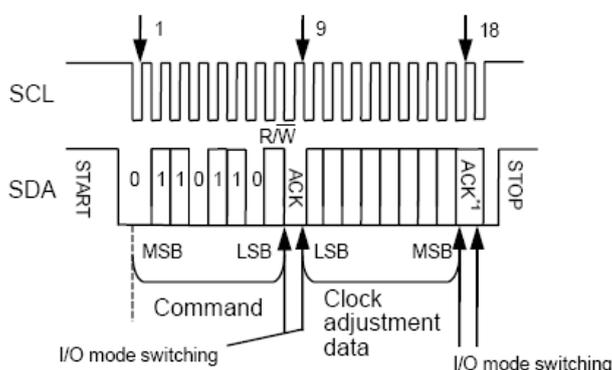
图 18 INT1 寄存器_1、INT1 寄存器_2 在为报警时刻数据寄存器时的读/写



- *1. 0: 选择 INT1 寄存器_1, 1: 选择 INT1 寄存器_2
- *2. 读操作时, 将 NO-ACK 置 1

图 19 INT1 寄存器_1、INT1 寄存器_2 在为频率占空比系数寄存器时的读/写

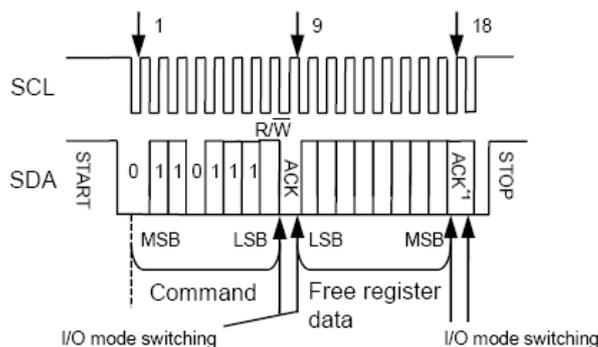
v. 时钟调整寄存器的读/写



- *1. 读操作时, 将 NO-ACK 置 1

图 20 时钟调整寄存器的读/写

vi. 通用寄存器的读/写



*1. 读操作时，将 NO-ACK 置 1

图 21 通用寄存器的读/写

(3) 不存在的数据与月份末数据的处理:

当写入实时时钟数据时，SD2200 会检测这个数据的有效性，并进行数据和月修正的处理。

表 6 不存在数据的处理

| 寄存器 | 正确数据 | 错误数据 | 改正结果 |
|----------------------|--------------|-------------------------------|------|
| 年数据 | 00-99 | XA-XF,AX-FX | 00 |
| 月数据 | 01-12 | 00,13-19,XA-XF | 01 |
| 日数据 | 01-31 | 00,32-39,XA-AF | 01 |
| 星期数据 | 0-6 | 7 | 0 |
| 小时数据(24 小时制)*(12 小时) | 0-23 0-11 | 24-29,3X,XA-XF 12-19,XA-XF | 00 |
| 分钟数据 | 00-59 | 60-79,XA-XF | 00 |
| 秒数据** | 00-59 | 60-79,XA-XF | 00 |

(*) 用 12 小时制时，用 $\overline{AM/PM}$ 做标志。

用 24 小时制时， $\overline{AM/PM}$ 标志位被忽略，但在读操作时“0”表示 0~11 点，“1”表示 12~23 点。

(**) 关于不存在秒数据的处理：是在写完秒数据后产生一个进位脉冲，并将该进位脉冲送至分钟计数器。

[月末校正]任何不存在的日期都将被校正为下个月的第一天。例如：2 月 30 被改为 3 月 1 日。闰年的校正也在此完成。

6. 中断:

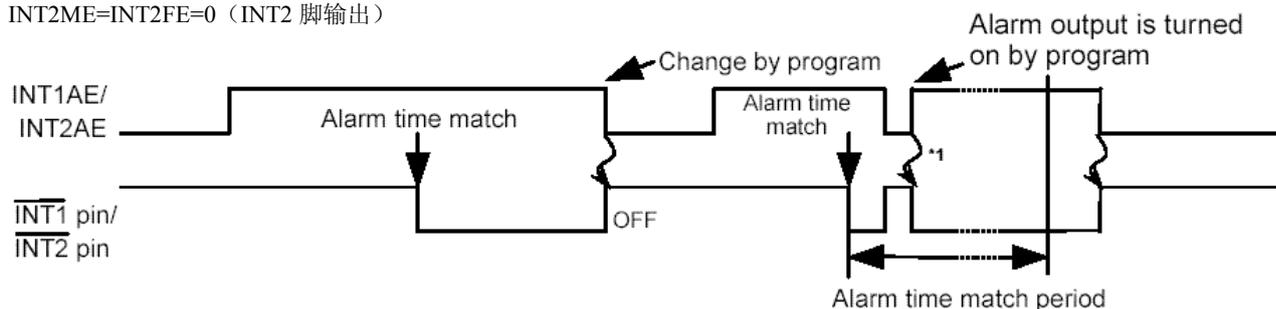
$\overline{INT1}$ 脚由状态寄存器_2 中的 INT1AE、INT1ME 与 INT1 FE 位来决定。同样， $\overline{INT2}$ 脚由状态寄存器_2 中的 INT2AE、INT2ME 与 INT2 FE 位来决定

(1) 报警中断输出:

用状态寄存器_2 来设置 $\overline{INT1}$ 脚 (或 $\overline{INT2}$ 脚) 的输出模式为报警设定，当用 INT1 寄存器_1(或 INT1 寄存器_2)进行星期、小时和分钟的设置时，若设定的时间与实时时间相一致，则从 $\overline{INT1}$ 脚 (或 $\overline{INT2}$ 脚) 输出“L”，因为输出状态被保持，因此只有通过将状态寄存器_2 的 INT1AE(或 INT2AE)设为“0”，来使其输出为“H”(OFF 状态)。

32kE=0、INT1AE=INT1ME=0 ($\overline{\text{INT1}}$ 脚输出)

INT2ME=INT2FE=0 ($\overline{\text{INT2}}$ 脚输出)



*1、在报警时刻一致时，因程序的改变使报警输出变为 ON 的情况下，会再一次从 $\overline{\text{INT1}}$ 脚（或 $\overline{\text{INT2}}$ 脚）输出“L”。

图 22 实时时钟报警中断输出时序

32kE = 0, INT1ME = INT1FE = 0

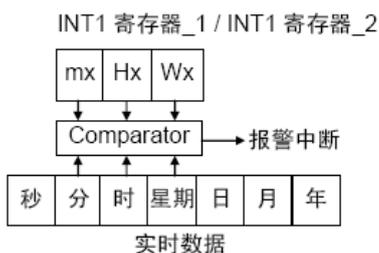
(INT1 端子输出模式)

INT2ME = INT2FE = 0

(INT2 端子输出模式)

报警有效标志

AxWE = AxHE = AxmE = “1” 时



32kE = 0, INT1ME = INT1FE = 0

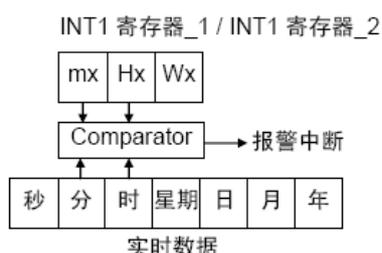
(INT1 端子输出模式)

INT2ME = INT2FE = 0

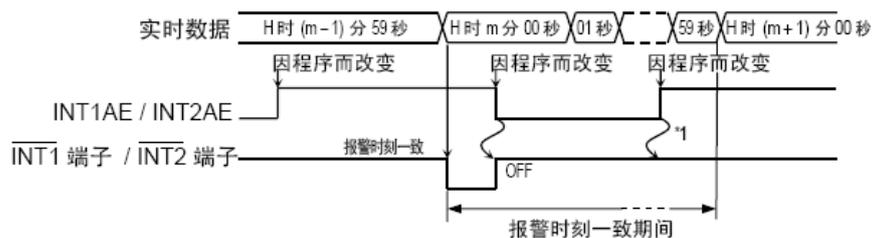
(INT2 端子输出模式)

报警有效标志

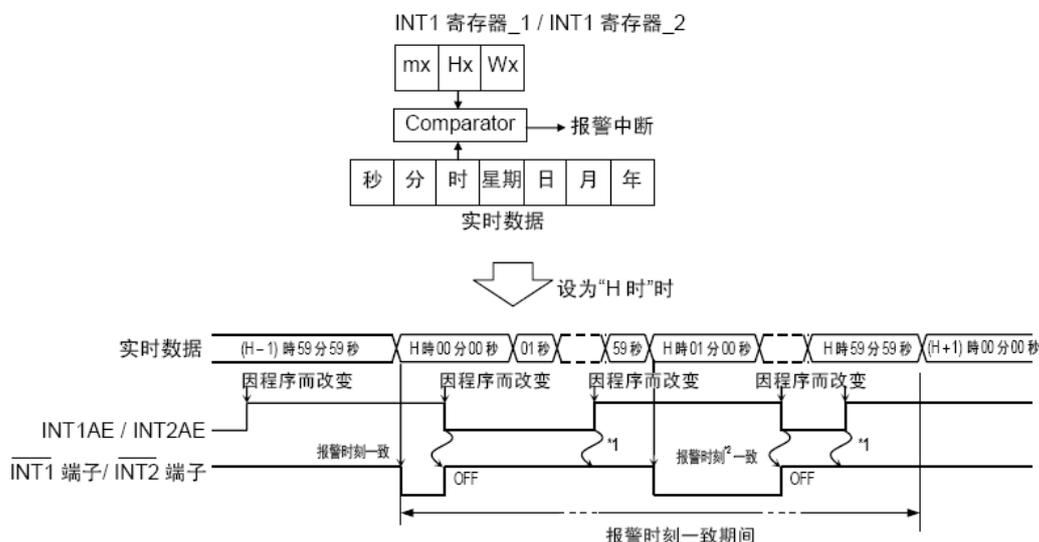
AxWE = “0”, AxHE = AxmE = “1” 时



↓ 设为“H 时 m 分”



32kE = 0, INT1ME = INT1FE = 0 ($\overline{\text{INT1}}$ 端子输出模式)
 INT2ME = INT2FE = 0 (INT2 端子输出模式)
 报警有效标志
 AxWE = AxmE = "0", AxHE = "1" 时



- *1. 一旦清除，在一致期间内即使再次设为有效， $\overline{\text{INT1}}$ 端子(或者 $\overline{\text{INT2}}$ 端子) 也不会输出“L”。
- *2. 在一致期间内因程序的改变使报警输出变为ON的情况下，在下一个分变化时会再一次从 $\overline{\text{INT1}}$ 端子输出“L”。

图 23 实时时钟报警中断输出详解

(2) 可选频率的固定中断输出

当用状态寄存器_2 将 INT1 脚 (或 INT2 脚) 输出模式设置为频率固定中断时,用 INT1 寄存器_1 (或 INT1 寄存器_2) 设置频率占空系数, 即 INT1ME = "0"、INT1FE = "1", 则所设定的时钟将从 $\overline{\text{INT1}}$ 脚 (或 INT2 脚) 输出。

32kE = 0, INT1ME = 0, INT1AE = Don't care (0或1)
 INT2ME = 0, INT2AE = Don't care (0或1)

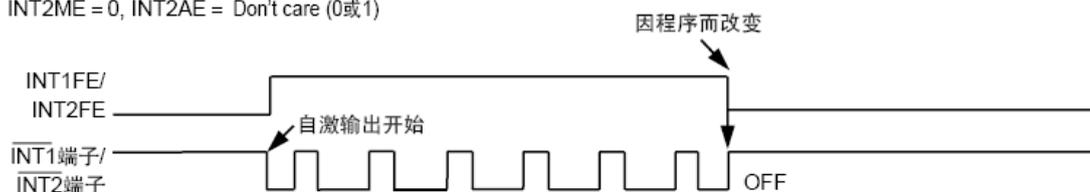


图 24 实时时钟可选频率的固定中断输出

(3) 每分钟边沿中断输出

置状态寄存器_2 的 INT1ME 为 "1"、INT1FE 为 "0" (或 INT2ME 为 "1" 或 INT2FE 为 "0") 以后,当出现置位之后的第一个分钟进位, 则将从 INT1 脚 (或 INT2 脚) 输出低电平。因为该输出被保持, 所以通过置状态寄存器_2 的 INT1AE、INT1ME 和 INT1FE 位 (或 INT2AE、INT2ME 和 INT2FE 位) 位为 "0", 可将输出转为高电平 (关状态)。在该分钟进位信号产生后的 123us 以内, 如果重置状态寄存器_2 的 INT1ME 为 "1"、INT1FE 为 "0" (或 INT2ME 为 "1"、INT2FE 为 "0"), 则从 $\overline{\text{INT1}}$ 脚(或 $\overline{\text{INT2}}$ 脚)再一次输出低电平信号。

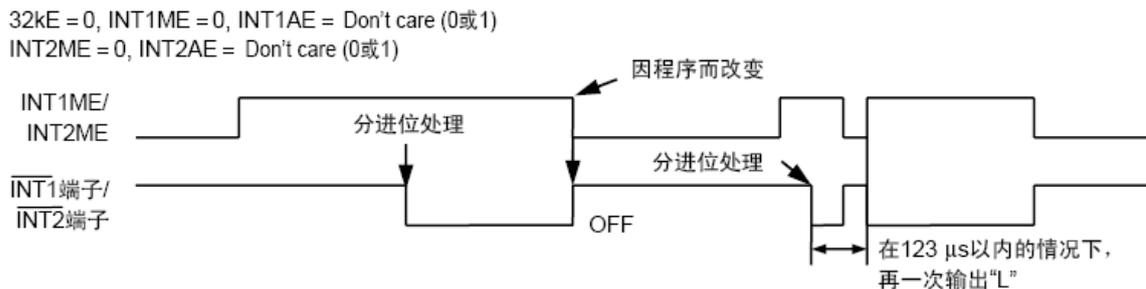


图 25 每分钟边沿中断输出

注意: 分钟进位信号在 123 μ s 时间内会被保持。因此,在这期间内, 进行每分钟边沿中断中断禁止+中断允许的操作时, 会再一次从 INT1 脚 (INT2 脚) 输出低电平。

(4)每分钟固定中断输出 1

置状态寄存器_2 的 INT1ME 和 INT1FE 位为” 1” (或 INT2ME 和 INT2FE 为” 1”)以后, 当出现置位之后的第一个分钟进位,则将从 INT1 脚(或 INT2) 输出周期为一分钟、占空比为 50%的连续方波信号。当 INTx 脚为高电平并且在分钟进位信号产生后的 123 μ s 以内,执行“允许”每分钟固定中断输出的命令, INTx 脚将再次输出低电平信号。

32kE = 0, INT1AE = 0 (INT1 端子输出模式)
INT2AE = 0 (INT2 端子输出模式)

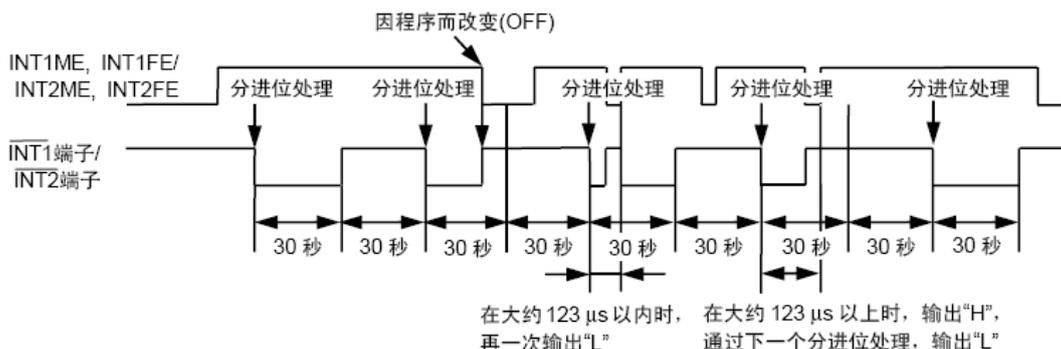


图 26 每分钟固定中断输出 1

注意: 在从 INT1 脚 (INT2 脚) 输出低电平期间内, 进行每分钟固定中断禁止+中断允许的操作时, 会再一次从 INT1 脚 (INT2 脚) 输出低电平。

(5) 每分钟固定中断输出 2 (仅 INT1 脚输出模式)

在状态寄存器_2 中设置 INT1 脚输出模式为每分钟固定中断之后, 当出现置位后的第一个分钟进位时, 则会在 7.9ms 内, 从 INT1 脚输出低电平, 但读出实时数据时, 分钟进位处理最多延时 0.5s。与其同步, 从 INT1 脚的输出也最多会延时 0.5 秒。另外, 通过实时数据写入指令改写秒数据时, 因为从所改写的秒数据开始计数, 所以, 此时的输出间隔会变长或变短。

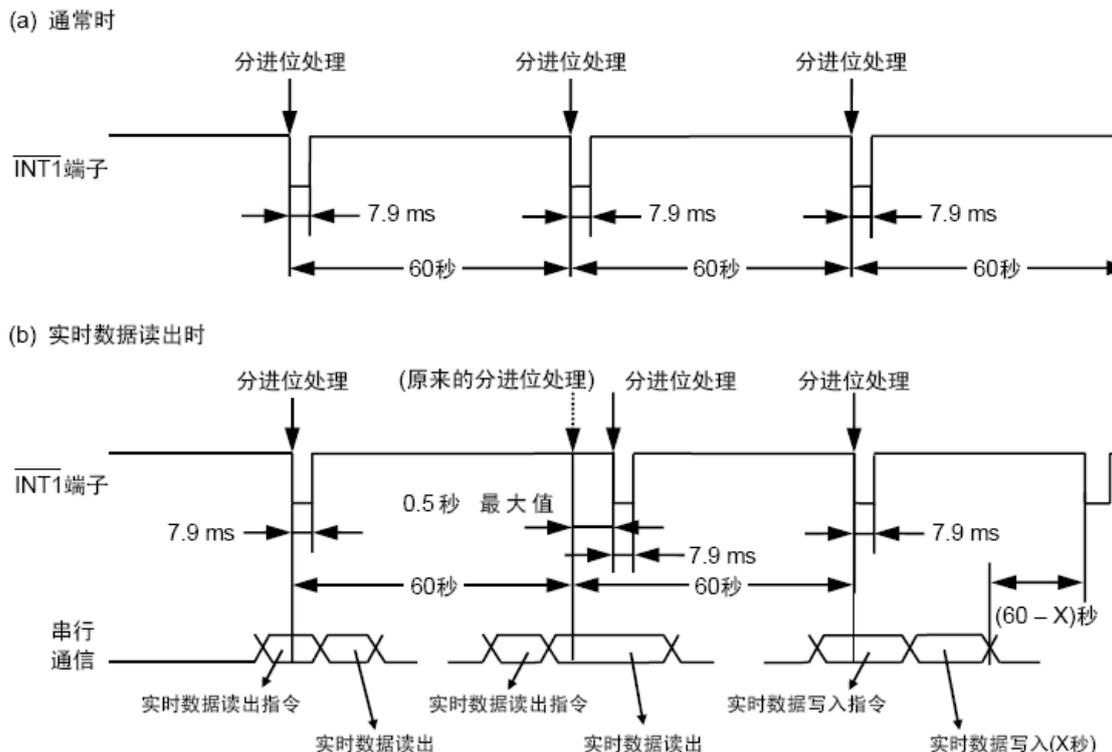


图 27 每分钟固定中断输出 2

- 注意：1、在输出模式转换时，请注意 INT1 寄存器_1(INT1 寄存器_2)及其输出状态。
 2、在选择每分钟边沿中断或每分钟固定中断时，INT1 寄存器_1(INT1 寄存器_2)无用。

(6) 在上电检测电路工作期间

$$INT2AE = INT2ME = INT2FE = 32kE = INT1AE = INT1ME = 0$$

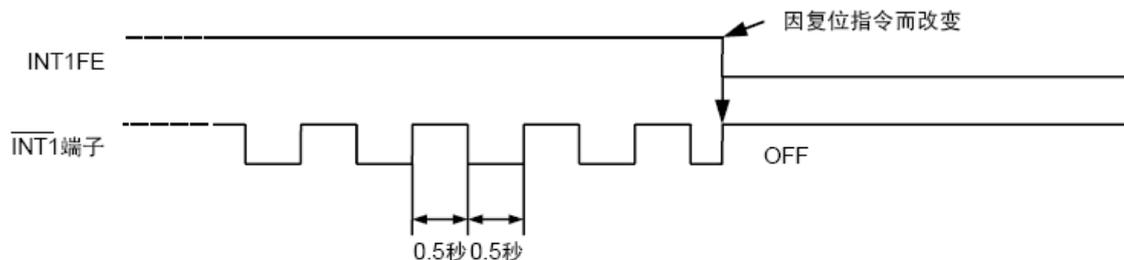


图 28 实时时钟上电检测电路工作期间

7. 时钟调整功能

时钟调整功能是从逻辑上调整 32kHz 的时钟功能，是为了调整时间的快进与慢进以取得更高精度的时间而准备的，并通过时钟调整寄存器来进行设置。在不使用本功能的情况下，请务必将其设定为“00h”。

- (1) 现在的振荡频率>目标频率的情况下（时间快时）

$$\text{寄存器值}^*1 = 128 - \left\lfloor \frac{(\text{现在的振荡频率实测值}^*2) - (\text{目标的振荡频率}^*3)}{(\text{现在的振荡频率}) \times (\text{最小分辨率}^*4)} \right\rfloor$$

*1 寄存器值为设定在时钟调整寄存器的值，请按此值的二进制变换值来设定时钟调整寄存器。

*2 1HZ 的时钟输出设定为:

32kE=0、INTIME=0、INTIFE=1, INT1 寄存器_1 为 01h 时,从 INT1 脚输出;

INT12ME=0、INT2FE=1, INT1 寄存器_2 为 01h 时,从 INT2 脚输出;

*3 使用时钟调整功能所调整的频率。

*4 利用最小分辨率可设定 3.052ppm 或者 1.017ppm, 通过时钟调整寄存器的 B7 来进行设定。B7 为“0”时设为 3.052ppm, 按每 20 秒进行逻辑快/慢补偿; B7 为“1”时设定为 1.017ppm, 按每 60 秒进行逻辑快/慢补偿。

表 7

| | B7=0 | B7=1 |
|-------|---------------------|-------------------|
| 快慢 | 每 20 秒 | 每 60 秒 |
| 最小分辨率 | 3.052ppm | 1.017ppm |
| 补偿范围 | -195.3ppm~+192.2ppm | -65.1ppm~+64.5ppm |

例子 1:

现在的振荡频率实测值=1.000080Hz,目标振荡频率=1.000000Hz,B7=0(即最小分辨率为 3.052ppm)。

$$\text{寄存器值} = 128 - \text{整数} \left(\frac{(1.000080) - (1.000000)}{(1.000080) \times (3.052 \times 10^{-6})} \right)$$

$$= 128 - \text{整数}(26.21) = 128 - 26 = 102$$

时钟调整寄存器设为

$$(B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0) = (0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0)$$

(2) 现在的振荡频率<目标频率的情况下(时间慢时)

$$\text{寄存器值} = \text{整数} \left(\frac{(\text{目标的振荡频率}) - (\text{现在的振荡频率实测值})}{(\text{现在的振荡频率}) \times (\text{最小分辨率})} \right) + 1$$

注: 寄存器值的可调范围为 0~62。

例子 2:

现在的振荡频率实测值=0.999920Hz,目标振荡频率=1.000000Hz,B7=0(即最小分辨率为 3.052ppm)。

$$\text{寄存器值} = \text{整数} \left(\frac{(1.000000) - (0.999920)}{(0.999920) \times (3.052 \times 10^{-6})} \right) + 1$$

$$= \text{整数}(26.21) + 1 = 26 + 1 = 27$$

时钟调整寄存器设为

$$(B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0) = (0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1)$$

例子 3:

现在的振荡频率实测值=0.999920Hz,目标振荡频率=1.000000Hz,B7=1(即最小分辨率为 1.017ppm)。

$$\text{寄存器值} = \text{整数} \left(\frac{(1.000000) - (0.999920)}{(0.999920) \times (1.017 \times 10^{-6})} \right) + 1$$

=整数(78.66)+1

因为超出了“0~62”的可调范围,所以在,B7=1(即最小分辨率为 1.017ppm)时不能进行调整。

■ 串行 NVSRAM 电路（适用于 SD2200 RAM 系列中的 B/C/D/E 型）

1. SRAM 数据传输协议(I²C 接口)

(1)开始条件/(2) 停止条件/(3)数据传输/(4)应答信号（Acknowledge bit）

如图 29 所示，以 SCLE 对应 SCL，以 SDAE 对应 SDA，参照本文有关实时时钟串行接口部分的描述。

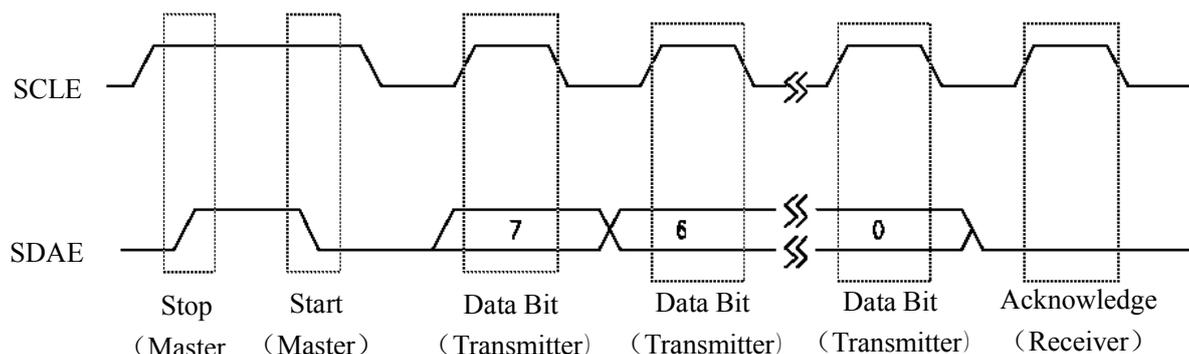
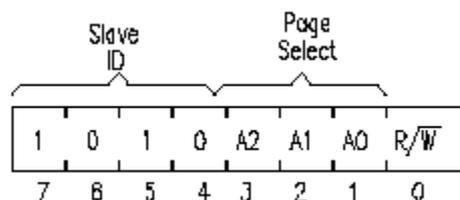


图 29 SRAM 数据传输

2. 操作指令

当 CPU 要对 SD2200 中的 SRAM 进行操作时，首先发出开始信号给 SD2200，然后 CPU 发出包括四位器件代码(固定为“1010”)、三位页地址、一位操作码（读操作为“1”，写操作为“0”)的八位数据，即为“从器件地址”（SLAVE ADDRESS）。



这八位从器件地址数据中三位页地址根据 SD2200 具体的型号而有所不同：

- (1) 当为 **B** 型 SD2200 时，该三位中的前两位被固定为“00”，后一位为页选码（SRAM 对数据的操作分为两页进行，每页的地址为 00—FFH，“0”为第一页，“1”为第二页）。
- (2) 当为 **C** 型 SD2200 时，该三位均为页选码（SRAM 对数据的操作分为八页进行，每页的地址为 00—FFH）。
- (3) 当为 **D** 型 SD2200 时，该三位被固定为“000”。
- (4) 当为 **E** 型 SD2200 时，该三位被固定为“000”。

表 8 SRAM 操作指令

| 型号 | 器件代码 | 三位页地址 | 操作码 | 页内范围 |
|-----|------|---------|----------|------------|
| B 型 | 1010 | 000~001 | 读“1”写“0” | 00~FFH |
| C 型 | 1010 | 000~111 | 读“1”写“0” | 00~FFH |
| D 型 | 1010 | 000 | 读“1”写“0” | 0000~1FFFH |
| E 型 | 1010 | 000 | 读“1”写“0” | 0000~7FFFH |

3. 写操作

写操作可分为两种，单字节写操作和连续写入操作。单字节写操作指每次只写入一个字节的数。连续写入操作指可以写入任意数量字节的数据。由于内置 NVSRAM 的存储容量的大小不同，因此在进行写操作时，其操作方

式有所不同。

(1) 单字节写操作

A) B型和C型SD2200单字节写操作

在单字节写操作下，主器件发送起始信号和从器件地址信息（R/W 位置0）给从器件。在从器件送回应答信号后，主器件发送一个8位地址字写入SRAM的地址计数器。主器件在收到SRAM的应答信号后再发送数据到被寻址的存储单元，SRAM再次应答并在主器件产生停止信号后开始内部数据的擦写（内部擦写周期小于300ns）。在内部擦写过程中，SRAM不再应答主器件的任何请求。

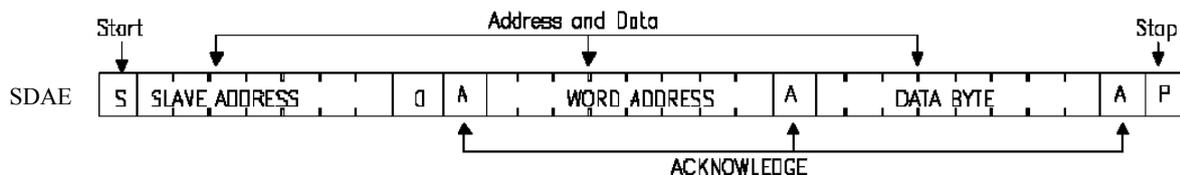
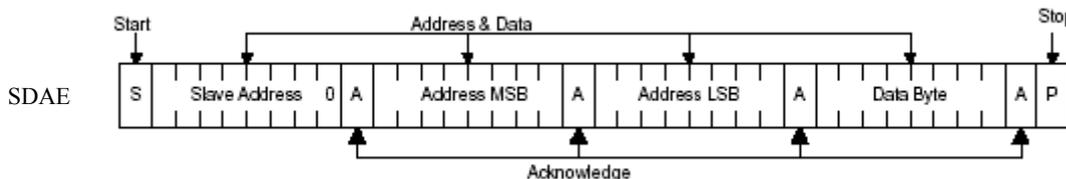


图30 B型和C型SD2200 SRAM单字节写操作

B) D型和E型SD2200单字节写操作

在单字节写操作下，主器件发送起始信号和从器件地址信息（R/W 位置0）给从器件。在从器件送回应答信号后，主器件首先发送高八位地址给SRAM，SRAM再次应答后主器件发送低八位地址给SRAM，主器件在收到SRAM的应答信号后再发送数据到被寻址的存储单元，SRAM再次应答并在主器件产生停止信号后开始内部数据的擦写。在内部擦写过程中，SRAM不再应答主器件的任何请求。

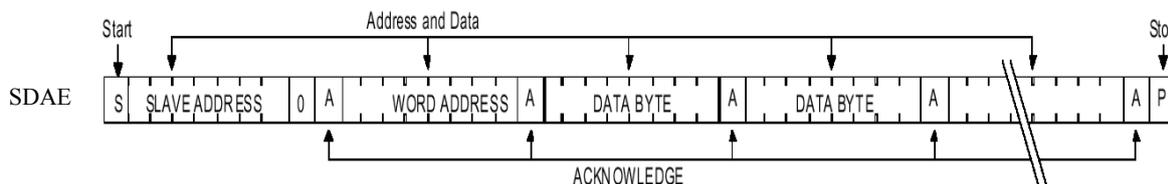


D型和E型SD2200 SRAM单字节写操作

(2) 连续写入操作

A) B型和C型SD2200连续写入操作

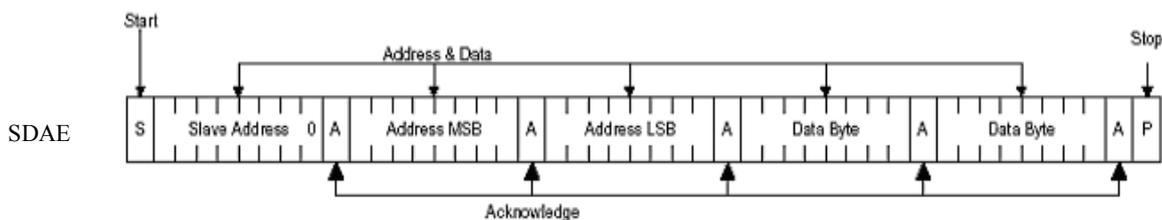
在连续写入操作下，单个写周期内SRAM可以被写入任意数量的数据。连续写入操作的启动与该型号的单字节写操作一样，区别在于传送了一字节数据后允许主器件继续发送n个字节的数据。每传送完一个字节数据后，SRAM响应一个应答信号且内部地址计数器（共9位或11位）自动加1。若地址计数器的值到达边界时，该值将从1FFH变为000H(B型)或7FFH变为000H(C型)。



B型和C型SD2200 SRAM连续写入操作

B) D型和E型SD2200的连续写入操作

在连续写入操作下，单个写周期内SRAM可以被写入任意数量的数据。连续写入操作的启动与该型号的单字节写操作一样，区别在于传送了一字节数据后允许主器件继续发送n个字节的数据。每传送完一个字节数据后，SRAM响应一个应答信号且内部地址计数器（共16位）自动加1。若地址计数器的值到达边界时，该值将从1FFFH变为0000H(D型)或从7FFFH变为0000H(E型)。



D型和E型SD2200 SRAM连续写入操作

4. 读操作

除读/写位被设定为“1”外，CPU以与写操作同样的方式初始化读操作。读操作有三种方式：立即地址读操作，随机地址读操作，连续读操作。同样由于内置NVS RAM的存储容量的大小不同，因此在进行读操作时，其操作方式有所不同。

(1) 立即地址读操作

B型、C型、D型、E型这四种型号的立即地址读操作的形式是一样的。SRAM的地址计数器内容为最后操作字节的地址加1，也就是说如果上次读/写的操作地址为N，则立即读的地址从地址N+1开始。如果N为边界值(分别为1FFH,7FFH,1FFFH,7FFFH)，则寄存器将会翻转到地址0继续输出数据。在SRAM接收到从器件地址以后(R/W=1)，它首先发送一个应答信号，然后发送一个8位字节数据。主器件不需要发送一个应答信号，但是要产生一个停止信号。

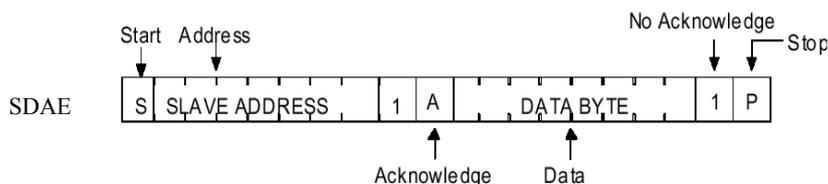


图31 SRAM读当前地址操作

(2) 随机地址读操作

随机读操作允许主器件对寄存器的任意字节进行读操作。主器件首先通过发送起始信号、从器件地址和它想读取的字节数据的地址(B型和C型为单字节地址，而D型和E型为双字节地址)给SRAM(此时R/W位置为0)。在SRAM应答之后，主器件重新发送起始信号和从器件地址(此时R/W位置为1)，SRAM响应并发送应答信号，然后输出所要求的一个8位字节数据，主器件不发送应答信号但要产生一个停止信号。

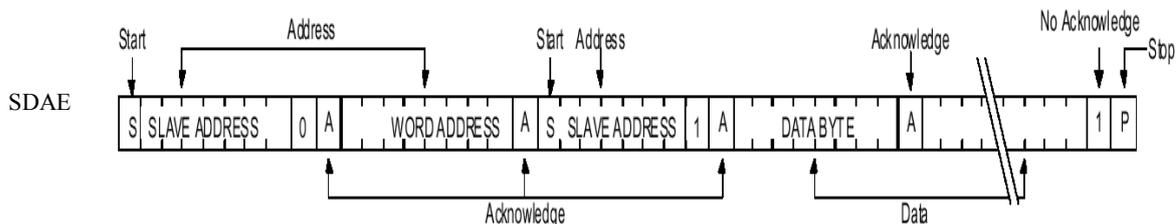


图32 B型和C型SD2200的SRAM随机地址读操作

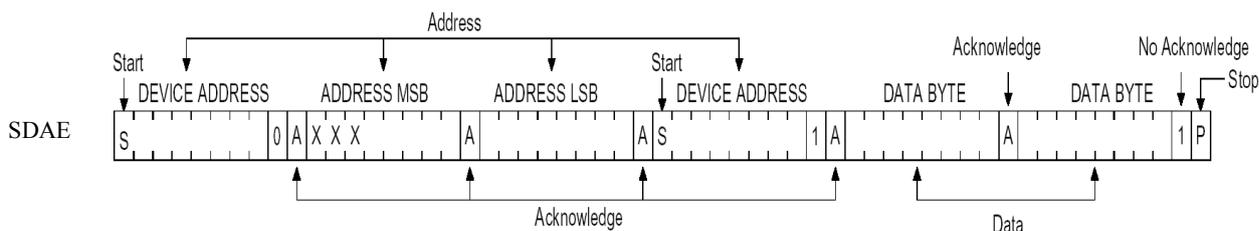


图33 D型和E型SD2200的SRAM随机地址读操作

(3) 连续读操作

B型、C型、D型、E型这四种型号连续地址读操作的形式也是一样的。连续读操作可通过立即读或选择性读操作方式启动。在SRAM发送完第一个8位字节数据后，主器件产生一个应答信号来响应，告知SRAM主器件要求更多的数据。对应每个主器件产生的应答信号SRAM将发送一个8位数据字节。当主器件不发送应答信号而发送停止信号时结束此操作。

从SRAM输出的数据按顺序由N到N+1输出。读操作时的地址计数器在SRAM整个寄存器区域增加，这样整个寄存器区域可在一个读操作内全部读出。若地址计数器的值到达边界时，该值将从(分别为1FFH,7FFH,1FFFH,7FFFH)变为000或0000H。

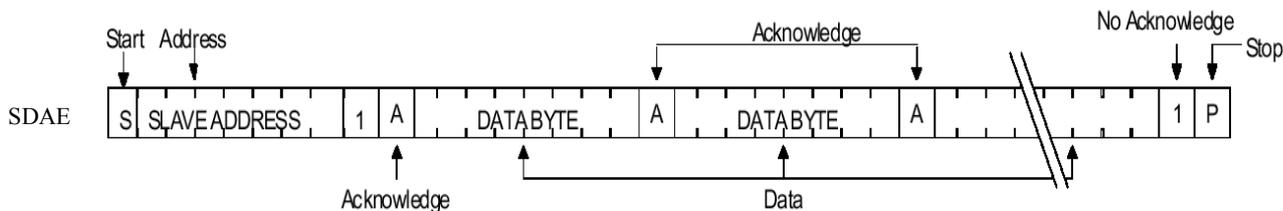


图 34 SRAM 连续读操作

■ 电气特性

3. 实时时钟部分电气特性:

(1) 绝对最大额定值:

| 项目 | 记号 | 适用端子 | 额定值 | 单位 |
|------|-----------|--|------------------------------|----|
| 电源电压 | V_{DD} | — | $V_{SS}-0.3 \sim V_{SS}+6.5$ | V |
| 输入电压 | V_{IN} | SCL, SDA | $V_{SS}-0.3 \sim V_{SS}+6.5$ | V |
| 输出电压 | V_{OUT} | SDA, $\overline{INT1}$, $\overline{INT2}$ | $V_{SS}-0.3 \sim V_{SS}+6.5$ | V |
| 工作温度 | T_{opr} | — | -40 ~ +85 | °C |
| 保存温度 | T_{stg} | — | -55 ~ +125 | °C |

注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值，有可能造成产品劣化等的物理性损伤。

(2) 推荐工作条件:

| 项目 | 记号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-----------|------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----|----|
| 电源电压 | V_{DD} | $T_a = -40 \sim +85^\circ\text{C}$ | 1.3 | 3.0 | 5.5 | V |
| 工作温度 | T_{opr} | $V_{DD} = 1.3 \sim 5.5\text{V}$ | -40 | +25 | +85 | °C |
| 计时电压范围 | V_{DDT} | $T_a = -40 \sim +85^\circ\text{C}$ | V_{DDTm} | — | 5.5 | V |
| 寄存器保持电压 | V_{DH} | $T_a = -40 \sim +85^\circ\text{C}$ | V_{DDTm} | — | 5.5 | V |
| 计时时最低电压范围 | V_{DDTm} | $T_a = -40 \sim +85^\circ\text{C}$ | 0.5 ^{*1} | — | 1.1 | V |

*1. 参考值。

(3) 直流电气特性:

($T_a = -40 \sim +85^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.0\text{V}$)

| 项目 | 记号 | 适用端子 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------------------|-----------|---|------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------|---------------|
| 消耗电流1 | I_{DD1} | — | 非通信时 | — | 0.25 | 0.93 | μA |
| 消耗电流2 | I_{DD2} | — | 通信时 ($SCL = 100\text{kHz}$) | — | 6 | 14 | μA |
| 输入泄漏电流1 | I_{IZH} | SCL, SDA | $V_{IN} = V_{DD}$ | -0.5 | — | 0.5 | μA |
| 输入泄漏电流2 | I_{IZL} | SCL, SDA | $V_{IN} = V_{SS}$ | -0.5 | — | 0.5 | μA |
| 输出泄漏电流1 | I_{OZH} | $\overline{INT1}$, $\overline{INT2}$, SDA | $V_{OUT} = V_{DD}$ | -0.5 | — | 0.5 | μA |
| 输出泄漏电流2 | I_{OZL} | $\overline{INT1}$, $\overline{INT2}$, SDA | $V_{OUT} = V_{SS}$ | -0.5 | — | 0.5 | μA |
| 输入电压1 | V_{IH} | SCL, SDA | — | $0.8 \times V_{DD}$ | — | — | V |
| 输入电压2 | V_{IL} | SCL, SDA | — | — | — | $0.2 \times V_{DD}$ | V |
| 输出电流1 | I_{OL1} | $\overline{INT1}$, $\overline{INT2}$ | $V_{OUT} = 0.4\text{V}$ | 3.0 | 5.0 | — | mA |
| 输出电流2 | I_{OL2} | SDA | $V_{OUT} = 0.4\text{V}$ | 5 | 10 | — | mA |
| 电源电压检测电压 ^{*1} | V_{DET} | — | $T_a = -40 \sim +85^\circ\text{C}$ | $V_{DDTm} + 0.15$ ^{*2} | — | $V_{DDTm} + 0.4$ | V |

*1. 请务必维持 $V_{DET} > V_{DDTm}$ (可计时最低电压)的关系。请参考特性例曲线。

*2. 参考值。

($T_a = -40 \sim +85^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 5.0\text{V}$)

| 项目 | 记号 | 适用端子 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------------------|-----------|---|------------------------------------|---------------------------------|-----|---------------------|---------------|
| 消耗电流1 | I_{DD1} | — | 非通信时 | — | 0.3 | 1.1 | μA |
| 消耗电流2 | I_{DD2} | — | 通信时 ($SCL = 100\text{kHz}$) | — | 14 | 30 | μA |
| 输入泄漏电流1 | I_{IZH} | SCL, SDA | $V_{IN} = V_{DD}$ | -0.5 | — | 0.5 | μA |
| 输入泄漏电流2 | I_{IZL} | SCL, SDA | $V_{IN} = V_{SS}$ | -0.5 | — | 0.5 | μA |
| 输出泄漏电流1 | I_{OZH} | $\overline{INT1}$, $\overline{INT2}$, SDA | $V_{OUT} = V_{DD}$ | -0.5 | — | 0.5 | μA |
| 输出泄漏电流2 | I_{OZL} | $\overline{INT1}$, $\overline{INT2}$, SDA | $V_{OUT} = V_{SS}$ | -0.5 | — | 0.5 | μA |
| 输入电压1 | V_{IH} | SCL, SDA | — | $0.8 \times V_{DD}$ | — | — | V |
| 输入电压2 | V_{IL} | SCL, SDA | — | — | — | $0.2 \times V_{DD}$ | V |
| 输出电流1 | I_{OL1} | $\overline{INT1}$, $\overline{INT2}$ | $V_{OUT} = 0.4\text{V}$ | 3.0 | 8.0 | — | mA |
| 输出电流2 | I_{OL2} | SDA | $V_{OUT} = 0.4\text{V}$ | 6 | 13 | — | mA |
| 电源电压检测电压 ^{*1} | V_{DET} | — | $T_a = -40 \sim +85^\circ\text{C}$ | $V_{DDTm} + 0.15$ ^{*2} | — | $V_{DDTm} + 0.4$ | V |

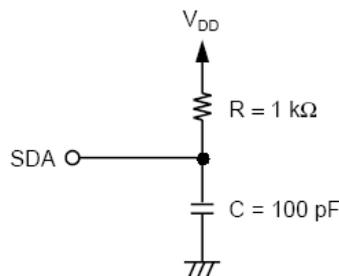
*1. 请务必维持 $V_{DET} > V_{DDTm}$ (可计时最低电压)的关系。请参考特性例曲线。

*2. 参考值。

(4) 交流电气特性

测定条件

| | |
|-------------|--|
| 输入脉冲电压 | $0.1 \times V_{DD} \sim 0.9 \times V_{DD}$ |
| 输入脉冲上升/下降时间 | 20 ns |
| 输出判定电压 | $0.5 \times V_{DD}$ |
| 输出负载 | 100 pF+上拉电阻 1 k Ω |



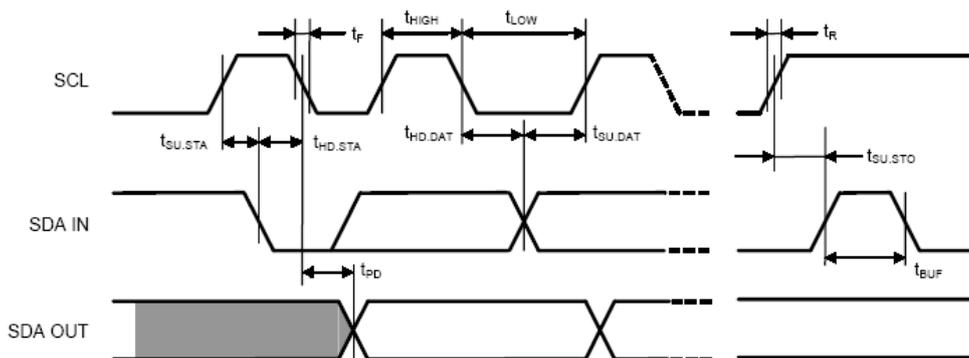
备注 IC的电源与负载的电源处相同电位

AC特性

(Ta = -40 ~ +85°C)

| 项目 | 记号 | V _{DD} = 1.3 ~ 5.5 V | | | V _{DD} = 3.0 ~ 5.5 V | | | 单位 |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| SCL时钟频率 | f _{SCL} | 0 | — | 100 | 0 | — | 400 | kHz |
| SCL时钟“L”时间 | t _{LOW} | 4.7 | — | — | 1 | — | — | μs |
| SCL时钟“H”时间 | t _{HIGH} | 4 | — | — | 0.9 | — | — | μs |
| SDA输出延迟时间 ^{*1} | t _{PD} | — | — | 3.5 | — | — | 0.9 | μs |
| 开始状态设置时间 | t _{SU.STA} | 4.7 | — | — | 0.6 | — | — | μs |
| 开始状态保持时间 | t _{HD.STA} | 4 | — | — | 0.6 | — | — | μs |
| 数据输入设置时间 | t _{SU.DAT} | 250 | — | — | 100 | — | — | ns |
| 数据输入保持时间 | t _{HD.DAT} | 0 | — | — | 0 | — | — | ns |
| 停止状态设置时间 | t _{SU.STO} | 4.7 | — | — | 0.6 | — | — | μs |
| SCL·SDA上升时间 | t _R | — | — | 1 | — | — | 0.3 | μs |
| SCL·SDA下降时间 | t _F | — | — | 0.3 | — | — | 0.3 | μs |
| 总线解放时间 | t _{BUF} | 4.7 | — | — | 1.3 | — | — | μs |
| 噪声抑制时间 | t _I | — | — | 100 | — | — | 50 | ns |

*1. 由于SDA端子的输出形态是N沟道开路漏极输出，所以SDA输出延迟时间因IC外部的负载电阻(R_L)、负载容量(C_L)值的不同而决定。因此请作为参考值。

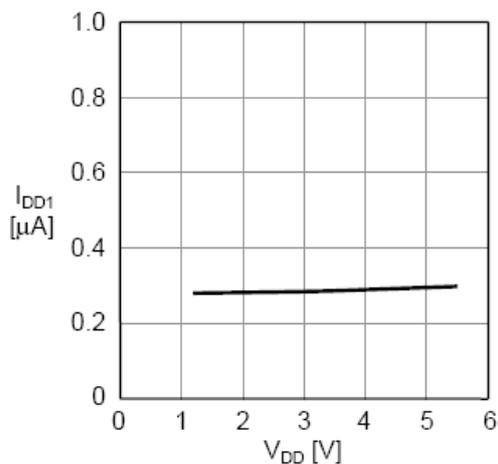


总线时序

(5) 特性曲线

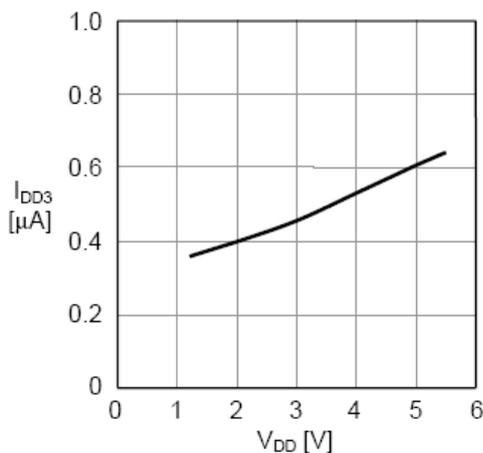
待机电流 - V_{DD}特性

Ta = 25°C



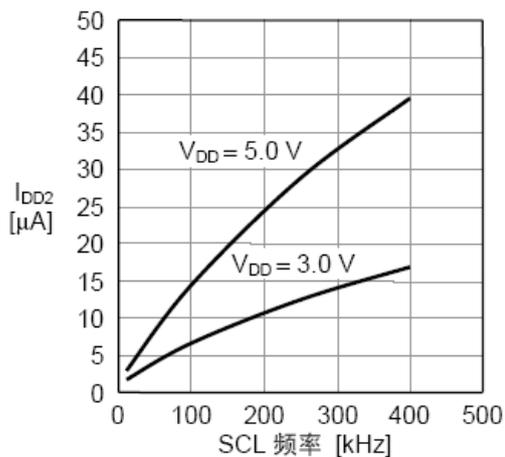
32 kHz输出时消耗电流 - V_{DD}特性

Ta = 25°C

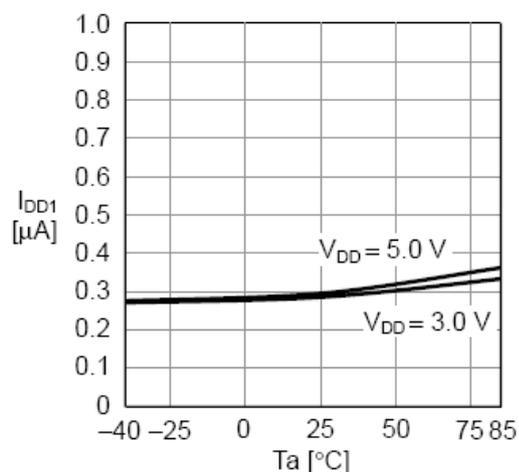


工作时消耗电流 — 输入时钟特性

$T_a = 25^\circ\text{C}$

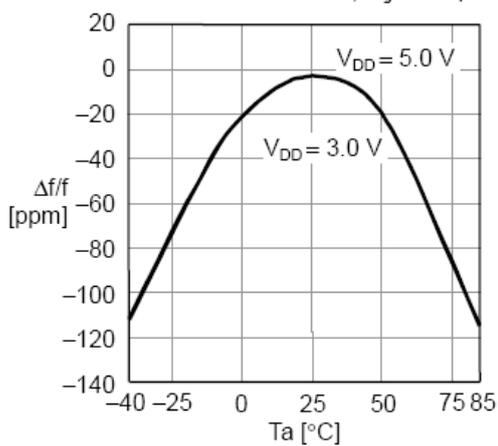


待机电流 — 温度特性



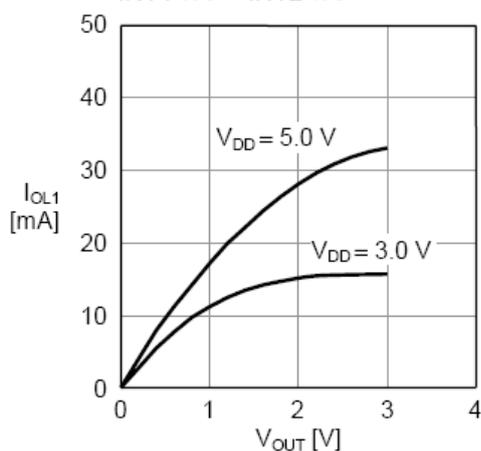
振荡频率 — 温度特性

$T_a = 25^\circ\text{C}, C_g = 7.5\text{ pF}$



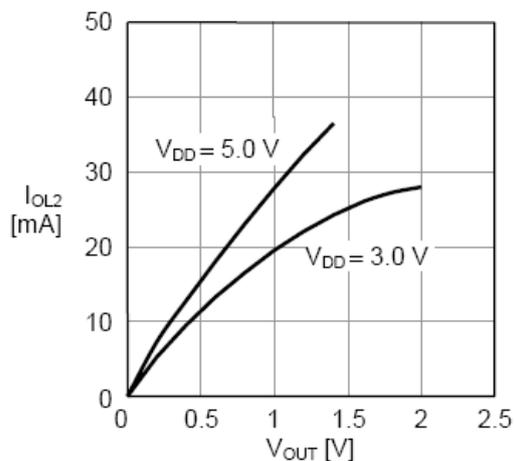
输出电流特性1 ($V_{OUT} - I_{OL1}$)

INT1端子、INT2端子、 $T_a = 25^\circ\text{C}$

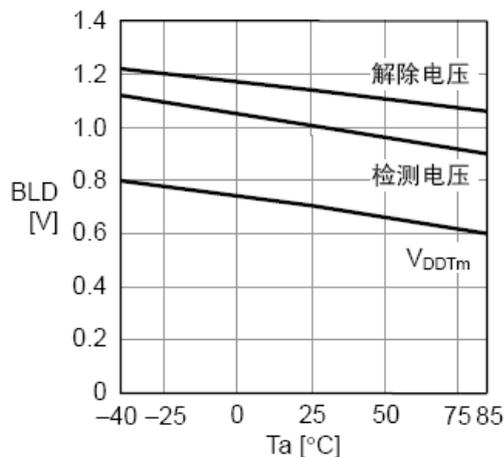


输出电流特性2 ($V_{OUT} - I_{OL2}$)

SDA端子、 $T_a = 25^\circ\text{C}$



BLD检测、解除电压、 V_{DDTm} — 温度特性



4. 串行 NVSRAM 部分电气特性:

(1) 直流电气特性(TA = -40° C to 85° C, VDD = 4.5V to 5.5V)

| 符号 | 参数 | 最小值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|------------------|------------------------------------|----------------------|-----|----------------------|-----|------|
| V _{DD} | 主电源 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | 1 |
| I _{DD} | V _{DD} 供电电流(@SCLE=100KHz) | | 115 | 150 | μ A | 2 |
| I _{DD} | V _{DD} 供电电流(@SCLE=400KHz) | | 400 | 500 | μ A | 2 |
| I _{SB} | 休眠电流 | | 1 | 10 | μ A | 3 |
| I _{LI} | 输入漏电流 | | | 10 | μ A | 4 |
| I _{LO} | 输出漏电流 | | | 10 | μ A | 4 |
| V _{IL} | 输入低电压 | -0.3 | | V _{DD} ×0.3 | V | 5 |
| V _{IH} | 输入高电压 | V _{DD} ×0.7 | | V _{DD} +0.5 | V | 5 |
| V _{OL} | 输出低电压(@I _{OL} =3mA) | | | 0.4 | V | 1, 5 |
| V _{OL} | 输出低电压(@I _{OL} =6mA) | | | 0.6 | V | 1, 5 |
| V _{HYS} | 输入滞后 | V _{DD} ×0.5 | | | V | 1, 5 |

- 备注:
1. 参考电压 V_{SS}。
 2. SCL 在 V_{DD}-0.3V 和 V_{SS} 之间触发, 其它输入为 V_{SS} 或 V_{DD}-0.3V。
 3. SCL=SDA=V_{DD}, 所有输入为 V_{SS} 或 V_{DD}。停止命令被发送。
 4. V_{IN} 或 V_{OUT}=V_{SS}~V_{DD}。
 5. 此参数是经抽样而非 100%测试得到的。

(2) 交流电气特性(TA = -40° C to +85° C, VDD = 4.5V to 5.5V)

| 符号 | 参数 | 标准模式 | | 快速模式 | | 单位 |
|---------|------------------------|------|------|----------|-----|-----|
| | | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |
| fSCLE | SCLE 时钟频率 | 0 | 100 | 0 | 400 | KHz |
| tSP | 噪音抑制时间(SCLE,SDAE 保持稳定) | | 50 | | 50 | ns |
| tAA | SCLE 低电平到 SDAE 输出有效 | | 3 | | 0.9 | μ s |
| tBUF | 在新传输前释放总线 | 4.7 | | 1.3 | | μ s |
| tHD:STA | 开始条件保持时间 | 4.0 | | 0.6 | | μ s |
| tLOW | 时钟低电平时间 | 4.7 | | 1.3 | | μ s |
| tHIGH | 时钟高电平时间 | 4.0 | | 0.6 | | μ s |
| tSU:STA | 开始条件设定时间 | 4.7 | | 0.6 | | μ s |
| tHD:DAT | 数据输入保持 | 0 | | 0 | | ns |
| tSU:DAT | 数据输入设定 | 250 | | 100 | | ns |
| tRISE | SDAE,SCLE 上升时间 | | 1000 | 20+0.1cb | 300 | |
| tFALL | SDAE,SCLE 下降时间 | | 300 | 20+0.1cb | 300 | ns |
| tSU:STO | 停止条件设定 | 4.0 | | 0.6 | | μ s |
| tDH | 数据输出保持(从 SCLE@VIL) | 0 | | 0 | | ns |
| tOF | 输出下降时间(VIN 从最小到最大) | | 250 | 20+0.1cb | 250 | ns |

| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
|------|----------------|-----|----|
| CI/O | 输入/输出电容 (SDAE) | 8 | pF |
| CIN | 输入电容 | 6 | pF |

注意：1.Cb=一条总线上的总电容数（以 pF 为单位）

2.开始和停止条件时序参数都应用在读和写电路中。对于读和写电路来说时钟规范是相同的。对于表中的各参数，请参照下面的时序图。

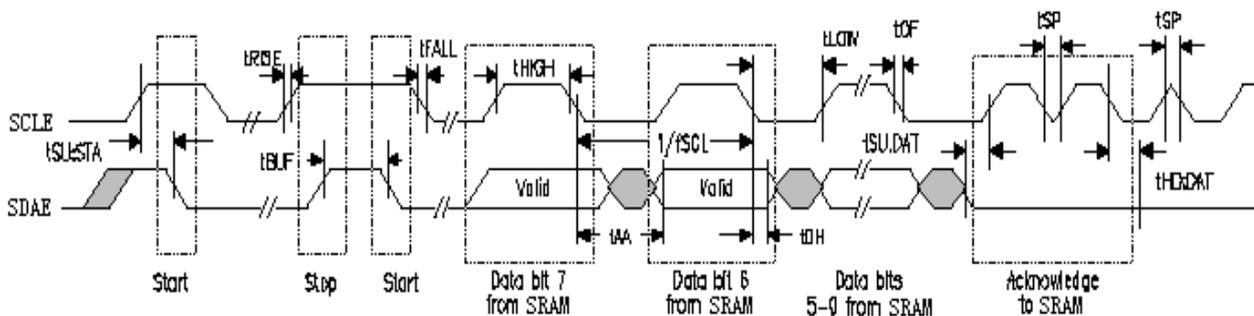


图 35 SRAM 读总线时序

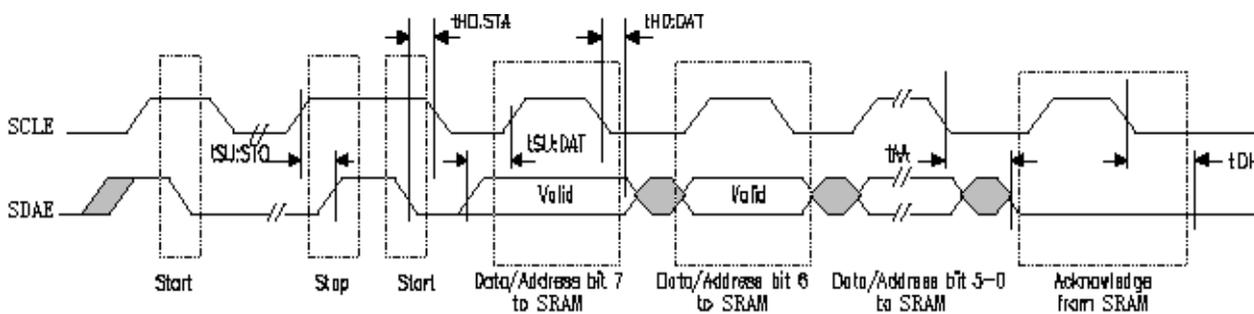


图 36 SRAM 写总线时序

■ 电源管理电路

1 内部电源管理电路(电源切换电路)

当 VDD>3.0V 时，则内部电池停止供电，改由外部电源 VDD 供电。在外部电源掉电情况下，内部电池保证时钟继续可靠运行，内置电池使用寿命——一次性民用级：3~5 年，一次性工业级和充电型：5~8 年；当电池能量耗尽后，可通过 VBAT 引脚采用备份电源供电，并可以通过 TEST 引脚测量电池电压。

2. 稳压电路

模块内部有稳压电路，可以对外加电源电压进行滤波、稳压，使模块工作始终工作在稳定状态。

3. 充电电路

芯片内部有充电电路,只要 VDD 超过 3.3V,充电电路就会开始工作,可保证对充电电池进行连续可靠的充电。

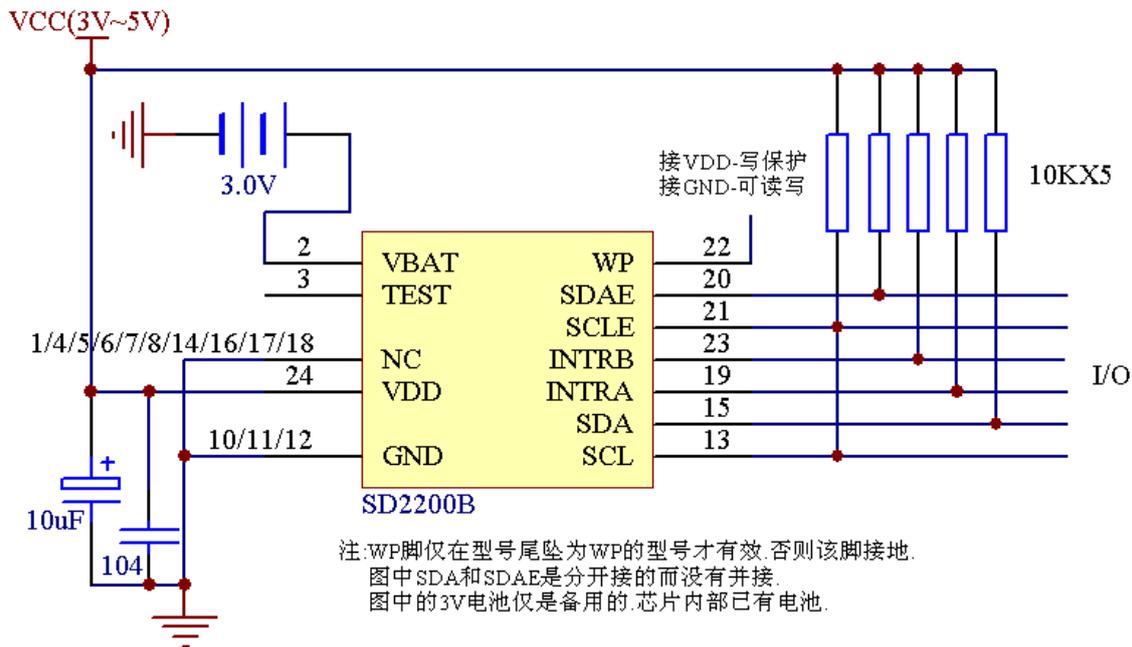
■ 使用说明

1. 为了防止电路噪声问题,请在此芯片的旁边两个放置旁路电容,分别是 0.1uF 电容和 22uF 电容。
2. 为了防止干扰,在 PCB 制作时请保证芯片底部无大电流信号通过,最好能铺地。
3. 特别注意:当 VDD 脚的电压低于 3.0V 时不可读/写时钟,否则内部电池电量将在一天内耗光!!!。
4. 使用时,除 TEST、VBAT、INT1、INT2 脚外,其它不用的脚接地。
5. 其它的一些应用注意事项请参考本公司网页

<http://www.whwave.com.cn/download/sd2200/sd2200all.asp>

应用电路与程序

(1) 应用电路:



(2) 程序下载: <http://www.whwave.com.cn/download/sd2200/sd2200all.asp>

封装尺寸 (单位: 毫米)

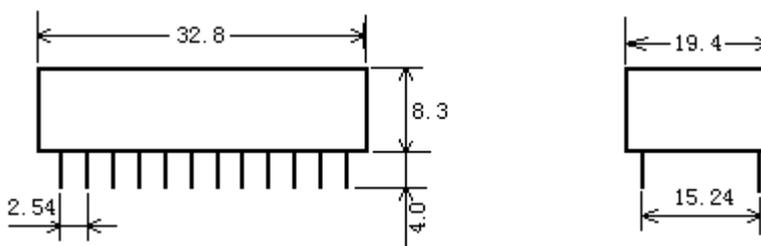


图 37 SD2200 系列封装尺寸 (管脚直径: 0.5mm)

编后语

感谢您阅读本资料。由于经验和水平的欠缺, 本文难免有错误和遗漏。如果您在使用过程中发现错误或不恰当的地方, 请拨打电话: 0755-83246178 或请 E-mail: chendw@whwave.com.cn, 我们将尽快予以答复。

感谢您的支持与合作!

注:

本资料中的内容如有变化, 恕不另行通知。

本资料提供的应用线路及程序仅供参考, 本公司不承担由此而引起的任何损失。

由于本公司的产品不断更新和提高, 希望您经常与本公司联系, 以索取最新资料。

本公司不承担在任何使用过程中引起的侵犯第三方专利和其它权利的责任。